

(12) NACH DEM VERTRÄG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
24. Oktober 2002 (24.10.2002)

PCT

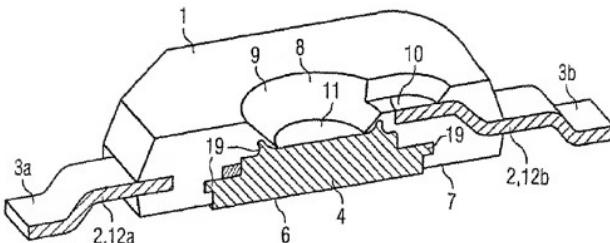
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 02/084749 A2**

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **H01L 33/00**
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE02/01306
- (22) Internationales Anmeldedatum:  
9. April 2002 (09.04.2002)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:  
101 17 889.1 10. April 2001 (10.04.2001) DE
- (72) Erfinder und  
Erfinder/Anmelder (nur für US): BOGNER, Georg  
[DE/DE]; Am Sandbügel 12, 93138 Lappersdorf (DE),  
BRUNNER, Heribert [DE/DE]; Winkergasse 16, 93047  
Regensburg (DE). HIEGLER, Michael [DE/DE]; Killer-  
mannstr. 45, 93049 Regensburg (DE). WAITL, Günter  
[DE/DE]; Praschweg 3, 93049 Regensburg (DE).
- (75) (74) Anwalt: EPPING HERMANN & FISCHER; Ridler-  
straße 55, 80339 München (DE).
- (81) Bestimmungstaaten (national): CN, JP, US.
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH &  
CO. OHG [DE/DE]; Wernerwerkstr. 2, 93049 Regensburg  
(DE).
- (84) Bestimmungstaaten (regional): europäisches Patent (AT,  
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,  
NL, PT, SE, TR).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) **Title:** CONDUCTOR FRAME AND HOUSING FOR A RADIATION-EMITTING COMPONENT, RADIATION EMITTING  
COMPONENT AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

(54) **Bezeichnung:** LEITERRAHMEN UND GEHÄUSE FÜR EIN STRAHLUNGSEMITTERENDES BAUELEMENT, STRAHL-  
UNGSEMITTERENDES BAUELEMENT SOWIE VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG



**WO 02/084749 A2**

(57) **Abstract:** The invention relates to a conductor frame (2) and a housing, in addition to a radiation-emitting component formed therewith and a method for the production thereof. The conductor frame has a support part with at least one binding wire connecting area (10) and at least one electric soldered connecting strip (3a,b), in which a separately built thermal connecting part (4) having a chip assembly area (11) is attached. In order to form the housing, the conductor frame (2) is enveloped with a molded material, wherein the thermal connecting part is embedded in such a way that it can be thermally connected from the outside.

(57) **Zusammenfassung:** Die Erfindung beschreibt einen Leiterrahmen (2) und ein Gehäuse sowie ein damit gebildetes strahlungs-  
emittierendes Bauelement und ein Verfahren zu dessen Herstellung. Der Leiterrahmen weist dabei ein Trägerteil mit mindestens  
einem Bonddrahtanschlussbereich (10) und mindestens einem elektrischen Lötanschlussstreifen (3a,b) auf, in das ein separat gefertigtes thermisches Anschlussstück (4) eingeknüpft ist, das einen Chipmontagebereich (11) aufweist. Zur Bildung eines Gehäuses ist  
der Leiterrahmen (2) vorzugsweise mit einer Formmasse umhüllt, wobei das thermische Anschlussstück so eingebettet wird, dass es  
von außen thermisch anschließbar ist.



**Veröffentlicht:**

- ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichten nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("*Guidance Notes on Codes and Abbreviations*") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2004-521506

(P2004-521506A)

(43) 公表日 平成16年7月15日(2004.7.15)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>  
H01L 33/00F 1  
H01L 33/00テーマコード(参考)  
5FO41

		審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 54 頁)	
(21) 出願番号	特願2002-581592(P2002-581592)	(71) 出願人	599133716
(60) (22) 出願日	平成14年4月9日(2002.4.9)		オスラム オプト セミコンダクターズ
(65) 翻訳文提出日	平成15年10月9日(2003.10.9)		ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテ
(66) 國際出願番号	PCT/DE2002/001306		ル ハウジング
(67) 國際公開番号	W02002/084749		Osram Opto Semicond
(68) 國際公開日	平成14年10月24日(2002.10.24)		uctors GmbH
(31) 優先権主張番号	101 17 889.1		ドイツ連邦共和国 レーゲンスブルク ヴ
(32) 優先日	平成13年4月10日(2001.4.10)		エルナーヴェルクシュトラーゼ 2
(33) 優先権主張国	ドイツ(DE)	(74) 代理人	100061815
(81) 指定国	EP(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), CN, JP, US		弁理士 矢野 敏雄
		(74) 代理人	100094798
			弁理士 山崎 利臣
		(74) 代理人	100099483
			弁理士 久野 琢也

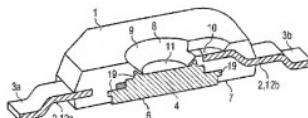
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】放射線を発する構成素子用いられる導体フレームおよびハウジング、放射線を発する構成素子ならびに該構成素子を製造するための方法

## (57) 【要約】

本発明は、導体フレーム(2)およびハウジングならびにこれによって形成された、放射線を発する構成素子および該構成素子を製造するための方法に関する。

導体フレームは、少なくとも1つのボンディングワイヤ接続範囲(10)と少なくとも1つの電気的なろう付け接続ストリップ(3a, 3b)とを備えた支持部分を有しており、この支持部分には、別個に製作された熱的な接続部分(4)が挿入結合されており、この熱的な接続部分(4)はチップ搭載範囲(11)を有している。ハウジングを形成するために、導体フレーム(2)は成形材料によって被覆されると有利であり、この場合、熱的な接続部分は、外部から熱的に接続可能となるよう埋め込まれる。



**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

放射線を発する構成素子、有利には発光ダイオード構成素子に用いられる導体フレーム（2）であって、少なくとも 1 つのチップ搭載範囲（11）と、少なくとも 1 つのワイヤ接続範囲（10）と、少なくとも 1 つの外部の電気的な接続ストリップ（3a, 3b）とが設けられている形式のものにおいて、支持部分が設けられていて、該支持部分がワイヤ接続範囲（10）と接続ストリップ（3a, 3b）とを有しております、該支持部分に、別個に製作された熱的な接続部分（4）が挿入結合されており、該熱的な接続部分（4）がチップ搭載範囲（11）を有していることを特徴とする、放射線を発する構成素子に用いられる導体フレーム。

**【請求項 2】**

支持部分がクランプまたはアイを有しております、該クランプまたはアイ内に熱的な接続部分（4）が挿入結合されている、請求項 1 記載の導体フレーム。

**【請求項 3】**

熱的な接続部分（4）と支持部分との間に、プレス結合部、リベット結合部、ろう付け結合部または溶接結合部が設けられている、請求項 1 または 2 記載の導体フレーム。

**【請求項 4】**

熱的な接続部分（4）がバスタブ形リフレクタ（16）を有しております、該バスタブ形リフレクタ（16）がチップ搭載範囲（11）を有している、請求項 1 から 3 までのいずれか 1 項記載の導体フレーム。

**【請求項 5】**

ワイヤ接続範囲（10）が、チップ搭載範囲（11）に対して、該チップ搭載範囲（11）から見て高くされて配置されている、請求項 4 記載の導体フレーム。

**【請求項 6】**

ワイヤ接続範囲（10）が、チップ搭載範囲（11）から見てバスタブ形リフレクタ（16）の縁部の上に配置されている、請求項 5 記載の導体フレーム。

**【請求項 7】**

バスタブ形リフレクタ（16）の高さ（A）が、チップ搭載範囲（11）へ搭載しようとするチップ（5）の高さ（H）の 2 倍を上回っていない、請求項 4、5 または 6 記載の導体フレーム。

**【請求項 8】**

熱的な接続部分（4）が C u、A l、M o、F e、N i または W を含有している、請求項 1 から 7 までのいずれか 1 項記載の導体フレーム。

**【請求項 9】**

チップ搭載範囲（11）が、チップ搭載を改善するための表面コーティングを備えている、請求項 1 から 8 までのいずれか 1 項記載の導体フレーム。

**【請求項 10】**

チップ搭載のための表面コーティングが A g 被覆体または A u 被覆体を有している、請求項 9 記載の導体フレーム。

**【請求項 11】**

当該導体フレーム（2）が C u または F e を含有している、請求項 1 から 10 までのいずれか 1 項記載の導体フレーム。

**【請求項 12】**

外部の電気的な接続ストリップ（3a, 3b）が、構成素子実装特性を改善するための表面コーティングを有している、請求項 1 から 11 までのいずれか 1 項記載の導体フレーム。

**【請求項 13】**

構成素子実装特性を改善するための表面コーティングが、A g 被覆体、A u 被覆体、S n 被覆体または Z n 被覆体を有している、請求項 12 記載の導体フレーム。

**【請求項 14】**

10

20

30

40

50

放射線を発する構成素子、有利には発光ダイオードに用いられるハウジングにおいて、当該ハウジングが、請求項1から13までのいずれか1項記載の導体フレーム(2)を有していることを特徴とする、放射線を発する構成素子に用いられるハウジング。

【請求項15】

当該ハウジングがハウジングベースボディ(1)を有しており、該ハウジングベースボディ(1)が成形材料から形成されており、該ハウジングベースボディ(1)内に、電気的な接続ストリップ(3a, 3b)がハウジングベースボディ(1)から導出されかつ熱的な接続部分(4)の熱接続面が外部から熱的に接続可能となるように導体フレーム(2)が埋め込まれている、請求項14記載のハウジング。

【請求項16】

ハウジングベースボディ(1)が放射線出射窓(8)を有しており、該放射線出射窓(8)内にチップ搭載範囲(11)が配置されるように熱的な接続部分(4)がハウジングベースボディ(1)内に埋め込まれている、請求項14または15記載のハウジング。

【請求項17】

放射線出射窓(8)の側壁(9)が反射面として成形されている、請求項16記載のハウジング。

【請求項18】

熱的な接続部分(4)がバスタブ形リフレクタ(16)を有しており、該バスタブ形リフレクタ(16)がリフレクタ(15)の第1の部分範囲を形成しており、該第1の部分範囲が、リフレクタ(15)の、放射線出射窓(8)の側壁(9)により形成された第2の部分範囲へ移行している、請求項17記載のハウジング。

20

【請求項19】

リフレクタ(15)の全高(B)が、チップ搭載範囲(11)に搭載しようとするチップ(5)の高さ(H)の4倍を上回っていない、請求項18記載のハウジング。

【請求項20】

バスタブ形リフレクタ(16)のリフレクタ壁と構成素子の主放射方向(27)とにより形成された角度と、放射線出射窓(8)に設けられた反射面と構成素子の主放射方向(27)とにより形成された角度とが、互いに異なっている、請求項18または19記載のハウジング。

30

【請求項21】

バスタブ形リフレクタ(16)のリフレクタ壁と前記主放射方向(27)とにより形成された角度が、放射線出射窓(8)の反射面と前記主放射方向(27)とにより形成された角度よりも大きく設定されている、請求項20記載のハウジング。

【請求項22】

当該ハウジングが表面実装可能である、請求項14から21までのいずれか1項記載のハウジング。

【請求項23】

放射線を発するチップ(5)を備えた、放射線を発する構成素子において、当該構成素子が、請求項1から13までのいずれか1項記載の導体フレーム(2)または請求項14から22までのいずれか1項記載のハウジングを有していることを特徴とする、放射線を発する構成素子。

40

【請求項24】

チップ(5)が半導体チップである、請求項23記載の構成素子。

【請求項25】

チップ(5)が、少なくとも部分的に、放射線透過性の材料(14)、特に封止用の流込み樹脂またはモールドコンパウンドのようなプラスチック材料で被覆されている、請求項23または24記載の構成素子。

【請求項26】

プラスチック材料がエポキシ樹脂、アクリル樹脂、シリコーン樹脂またはこれらの樹脂の混合物を含有している、請求項25記載の構成素子。

50

**【請求項 27】**

放射線透過性の材料（14）の容積（V）に関して：

$$V \leq q \cdot H$$

が成立し、この場合、Hはチップ（5）の高さであり、qは10mm<sup>2</sup>よりも小さな値、有利には7mm<sup>2</sup>である値を有するスケーリングファクタである、請求項25または26記載の構成素子。

**【請求項 28】**

チップ（5）が、熱的な接続部分（4）のチップ搭載範囲（11）に固定されている、請求項23から27までのいずれか1項記載の構成素子。

**【請求項 29】**

チップ（5）が、チップ搭載範囲（11）に接着されているか、またはろう付けされている、請求項28記載の構成素子。

**【請求項 30】**

チップ（5）が、硬ろうによってチップ搭載範囲（11）に固定されている、請求項29記載の構成素子。

**【請求項 31】**

硬ろうの溶融温度が260℃よりも高い、請求項30記載の構成素子。

**【請求項 32】**

チップ（5）がワイヤ接続範囲（10）にワイヤ結合部（17）によって導電接続されている、請求項23から31までのいずれか1項記載の構成素子。

**【請求項 33】**

請求項23から32までのいずれか1項記載の放射線を発する構成素子を製造するための方法において、

一支持部分を準備し、

- 該支持部分に、チップ搭載範囲（11）を有する熱的な接続部分（4）を挿入結合し、
- チップ搭載範囲（11）に、放射線を発するチップ（5）を被着させ、
- 支持部分（2）と熱的な接続部分（4）とをハウジング成形材料内に埋め込むことを特徴とする、放射線を発する構成素子を製造するための方法。

**【請求項 34】**

熱的な接続部分（4）を、リベット締結、プレス締結またはろう付けによって支持部分に結合する、請求項33記載の方法。

**【請求項 35】**

支持部分と熱的な接続部分（4）とをハウジング成形材料内に埋め込む前に、チップ（5）をチップ搭載範囲（11）に被着させる、請求項33または34記載の方法。

**【請求項 36】**

チップ（5）をチップ搭載範囲（11）にろう付けにより被着させ、ただしうる付け温度を260℃よりも高く設定する、請求項33から35までのいずれか1項記載の方法。

**【請求項 37】**

チップ（5）を硬ろうによってチップ搭載範囲（11）に固定する、請求項33から36までのいずれか1項記載の方法。

**【請求項 38】**

ハウジング成形材料内への支持部分（2）と熱的な接続部分（4）との埋込みを、射出成形法またはトランスマルク成形法によって行う、請求項33から37までのいずれか1項記載の方法。

**【発明の詳細な説明】****【技術分野】****【0001】**

本発明は、請求項1の上位概念部に記載の形式の導体フレーム、請求項14の上位概念部に記載の形式のハウジング、請求項23の上位概念部に記載の形式の、放射線を発する構成素子ならびに請求項33の上位概念部に記載の形式の、放射線を発する構成素子を製造

10

20

40

50

するための方法に関する。

#### 【0002】

放射線を発する半導体構成素子に用いられるリードフレームもしくは導体フレームは、たとえばドイツ連邦共和国特許第19636454号明細書に基づき公知である。同ドイツ連邦共和国特許明細書に記載の半導体構成素子は、ハウジングベースボディと、このハウジングベースボディ内に埋め込まれた導体フレームと、この導体フレーム上に搭載された、放射線を発する半導体チップとを有している。導体フレームとハウジングベースボディは、発生された放射線のためのリフレクタとしても形成されている。

#### 【0003】

さらに、導体フレームの、ハウジングベースボディから突出した部分範囲は、外部の電気的な接続ストリップとして形成されており、ハウジングは、当該構成素子が表面実装のために適切となるように成形されている。特に高い出力を有する半導体構成素子の場合に、発生する損失熱の良好な放出を達成するためには、リフレクタの一部が熱的な接続部、つまり熱端子としてハウジングベースボディから導出されていてよい。

10

#### 【0004】

高い光学的な出力と、相応して大きな損失出力を有する構成素子の場合では、一層効果的な放熱形式が望まれるか、もしくは必要とされる。

#### 【0005】

本発明の課題は、放射線を発する構成素子において、特に構成素子における高い光学的な出力の発生を可能にするような改善された熱導出手段もしくは放熱手段を提供することである。さらに、本発明の課題は、このための製造方法を提供することである。

20

#### 【0006】

上記課題は、請求項1に記載の導体フレーム、請求項14に記載のハウジング、請求項23に記載の放射線を発する構成素子もしくは請求項33に記載の方法により解決される。請求項2～請求項13、請求項15～請求項22、請求項24～請求項32ならびに請求項34～請求項38には、それぞれ本発明の有利な改良形が記載されている。

30

#### 【0007】

本発明の構成では、放射線を発する構成素子、有利には発光ダイオード構成素子に用いられる導体フレームであって、少なくとも1つのチップ搭載範囲と、少なくとも1つのワイヤ接続範囲と、たとえば放射線を発する構成素子をプリント配線板に実装しかつ電気的に接続するための少なくとも1つの外部の電気的な接続ストリップとが設けられている形式のものにおいて、支持部分が設けられていて、該支持部分が前記ワイヤ接続範囲と前記接続ストリップとを有しており、該支持部分、その他の導体フレーム部分とは別個に製作された熱的な接続部分が挿入結合されており、該熱的な接続部分にチップ搭載範囲が配置されているようにした。このような導体フレームを備えた構成素子では、作動時に生じる損失熱がとりわけ熱的な接続部分を介して導出される。この熱的な接続部分は支持部分に導電結合されていて、しかもチップのための電気的な接続部としても働くようになっていると有利である。

#### 【0008】

その他の導体フレーム部分とは別個に製作された熱的な接続部分は、次のような利点を持っている。すなわち、このような熱的な接続部分は、より大きな損失熱量の吸収および放出に関して、一体型の導体フレームよりも著しく良好に最適化することができる。すなわち、このような熱的な接続部分では、厚さ、熱伝導率、熱膨張率および熱接続面を、その他の導体フレーム部分に課せられた要求とは十分に無関係に、つまりこれらの要求の影響を受けることなしに、最適化することができる。特に熱的な接続部分では、高い熱容量を達成することができるので有利である。これにより、熱的な接続部分は効果的なヒートシンクを形成する。大きな熱接続面に基づき、熱伝達抵抗が減じられ、こうして熱伝導性および周辺への排熱が改善される。

40

#### 【0009】

本発明の有利な改良形では、支持部分が、たとえばクランプまたはアイ（目穴）の形の挿

50

入開口を有しており、この挿入開口内に熱的な接続部分が挿入結合されている。「挿入結合（e i n k n u e p f e n）」とは、熱的な接続部分が導体フレームの挿入開口に挿入されて、周面側で導体フレームと結合されていることを意味する。

#### 【0010】

このためには、熱的な接続部分が支持部分にたとえばクランプ締結されており、かつ／または支持部分とプレス締結またはリベット締結されていてよい。本発明によれば、熱的な接続部分と支持部分との間にプレス結合（圧潰結合）が形成されると有利である。このプレス結合は高い機械的強度および良好な導電率によりすぐれている。たとえば、支持部分に設けられた挿入開口に熱的な接続部分を挿入することによって支持部分と熱的な接続部分とを互いに対しても位置決めし、次いで支持部分における熱的な接続部分の機械的に強固な嵌合が生じるように熱的な接続部分を変形させることにより、プレス結合を形成することができます。変形のためには、ハンマ状またはポンチ状の工具を使用することができる。

#### 【0011】

熱的な接続部分は、リベットの形式で支持部分に結合され得るように成形されていると有利である。場合によっては、熱的な接続部分と支持部分との間に十分な強度のプレス結合を形成するために、熱的な接続部分に設けられた個々のウェブまたはステーを変形させることでも十分である。

#### 【0012】

本発明の枠内では、付加的にまたは択一的に、熱的な接続部分と支持部分との間に別形式の結合が設けられていてよい。このためには、たとえばろう付け結合または溶接結合が適している。さらに、熱的な接続部分が支持部分と接着されていてもよい。

#### 【0013】

こうして、比較的僅かな技術的手間をかけるだけで製造可能となる、半導体構成素子のための機械的に安定した骨組みが形成される。

#### 【0014】

熱的な接続部分が、バスタブ形、つまり洋式浴槽形に形成されたバスタブ形リフレクタを有していると有利である。これによって形成された構成素子では、熱的な接続部分により、構成素子の放射線収率およびビーム集束が改善される。本発明のこの改良形では、金属製の熱的な接続部分が使用されると有利である。なぜならば、金属面は小さな吸収損失および強力に方向付けられかつ場合によっては鏡面性の反射に基づき、反射面として極めて好適であるからである。

#### 【0015】

特に、以下にさらに詳しく説明するようなハウジングもしくは構成素子における機械的な安定性を高めるためには、熱的な接続部分に設けられたバスタブ形リフレクタの高さを、チップ搭載範囲に配置しようとするチップの高さの2倍を上回らないように設定することが有利である。

#### 【0016】

熱的な接続部分のための材料としては、高い熱伝導率に基づき、金属、特に銅またはアルミニウムまたはこれらの材料から形成された合金が適している。さらに有利な材料はモリブデン、鉄、ニッケルおよびタングステンならびにニッケル－鉄合金および銅－タングステン合金である。これらの材料の熱膨張率は半導体材料、たとえばGaN、GaNおよびこれらを主体とした系の熱膨張率に良好に適合されている。さらに、熱的な接続部分のための材料としては、セラミックスおよび半導体、たとえばシリコンも適している。熱的な接続部分は、多層に、たとえば金属－セラミック複合系として形成されていてもよい。

#### 【0017】

熱的な接続部分に設けられたチップ搭載面は、チップ被着に関する表面特性（ボンディング特性）を改善するコーティングを備えていると有利である。このようなコーティングは、たとえば銀被覆体または金被覆体を有していてよい。

#### 【0018】

さらに、ろう付け接続ストリップもしくはボンディングワイヤ接続範囲にも、ろう付け特

10

20

30

40

50

性もしくはボンディング特性を改善する表面コーティング、たとえばA u被覆体、A g被覆体、S n被覆体またはZ n被覆体を施与することが有利である。

#### 【0019】

支持部分は有利には銅または軟鉄を含有していて、たとえば相応するシートから打抜き加工され得る。支持部分は本発明によれば熱導出のためには働かない。したがって、支持部分は電流供給の機能のためや、曲げ特性および以下に詳しく説明する成形材料の付着に関して最適化され得る。

#### 【0020】

このことは、たとえば支持部分をロールからの支持テープから製作し、軽度に打抜き加工し、かつ型内で曲げ加工することができるよう支持部分の厚さが形成されていることを包含する。このような加工特性は、自動化された製作および支持テープ上の個別コンポーネントの密な配置（小ピッチ）を可能にするので有利である。

#### 【0021】

このために必要となる、支持部分の小さな厚さは、通常ではチップの十分な冷却を困難にする。特に機械的な安定性の理由から、熱的な接続部分の横断面は制限されている。このような不都合は、本発明によれば、挿入結合された熱的な接続部分によって取り除かれる。

#### 【0022】

本発明によれば、放射線を発する構成素子に用いられるハウジングを形成するために、リードフレームもしくは導体フレームがハウジングベースボディによって取り囲まれていると有利である。このためには、導体フレームが、ハウジングベースボディを形成する成形材料、たとえば射出成形材料またはトランシスファア成形法内に埋め込まれていると有利である。このことは射出成形法またはトランシスファア成形法におけるハウジングの廉価な製造を可能にする。成形材料は、たとえばエポキシ樹脂またはアクリル樹脂を主体としたプラスチック材料から成っているが、しかし当該目的のために適していればかかる材料から成っていてもよい。放熱もしくは熱導出のためには、熱的な接続部分が部分的にハウジングベースボディから突出するか、またはハウジングベースボディの表面の一部を形成し、ひいては外部から熱的に接続可能となるように熱的な接続部分を埋め込むことが有利である。

#### 【0023】

ハウジングベースボディには、放射線出射窓の形の切欠きが形成されていて、この放射線出射窓の内側にチップ搭載範囲が配置されるように熱的な接続部分がハウジングベースボディ内に埋め込まれていると有利である。たとえばチップ搭載範囲は放射線出射窓の輪郭を制限する制限面を形成していてよい。

#### 【0024】

このようなハウジング形状は、特に表面実装可能な構成素子のために適している。この場合、ハウジングベースボディの、放射線出射窓とは反対の側に位置する面または側面は構成素子の載置面を形成している。埋め込まれた熱的な接続部分はこの載置面にまで延びていると有利である。これにより、載置面を介して損失熱も、たとえば冷却体もしくはヒートシンクまたはPCB (printed circuit board、プリント配線板) へ排出される。この場合、熱的な接続部分の表面の一部が同時に載置面またはその部分面を形成するように熱的な接続部分を形成することが有利である。

#### 【0025】

放射線収率を向上させるためには、ハウジングベースボディに設けられた放射線出射窓が円錐状に成形されていてよい。これにより、放射線出射窓の側壁はリフレクタを形成する。このリフレクタにより、チップ搭載範囲に配置された放射線源から側方へ発せられた放射線成分を主放射方向へ向かって変向させることができる。これによって、放射線収率の向上および放射線の改善された集束が達成される。

#### 【0026】

リフレクタでは、熱的な接続部分がリフレクタの第1の部分範囲を形成し、この第1の部

10

20

30

40

50

分範囲に、放射線出射窓の側壁により成形された第2のリフレクタ部分範囲が続くような形状付与が行われていると有利である。リフレクタの全高は、チップ搭載範囲に固定しようととするチップの高さの4倍よりも小さく設定されていると有利である。このことは高い機械的安定性を保証すると同時に、たとえばろう付けプロセスの際に生じるような、温度変化に基づき発生する応力を許容し得る程度にまで制限する。

## 【0027】

さらに本発明によれば、本発明による導体フレームまたはハウジングを用いて、改善された熱導出を有する、放射線を発する構成素子を形成することが意図されている。このような構成素子は放射線を発するチップ、有利には半導体チップを有しており、このチップは熱的な接続部分のチップ搭載範囲に配置されている。

10

## 【0028】

チップは少なくとも部分的に封止用の流込み材料によって取り囲まれるように被覆されると有利である。このような構成は、放射線出射窓内に配置されたチップを備えたハウジングのために特に有利である。この場合、放射線出射窓の全体またはその一部が流込み材料で充填されている。流込み材料としては、特に反応樹脂、たとえばエポキシ樹脂、アクリル樹脂またはシリコーン樹脂またはこれらの混合物が適している。さらに、流込み材料には、チップにより形成された放射線を別の波長領域に変換する発光物質（Leuchtsstoff）が添加されていてよい。この構成は特に混色または白色の光線を放射する構成素子のために適している。

## 【0029】

ハウジングとチップと流込み材料との間での熱応力もしくは熱歪みを小さく保持し、かつ特に流込み材料カバーの離層を回避するためには、チップの高さHに関して次の関係：

$$V \leq q \cdot H$$

が満たされるように流込み材料容積Vを設定することが有利である。この場合、qは1.0 mm<sup>2</sup>よりも小さな値、有利には7 mm<sup>2</sup>である値を有するスケーリングファクタ（Skalierungsfaktor）である。

20

## 【0030】

本発明の有利な改良形では、導体フレームが、第1の電気的な接続部分と、第2の電気的な接続部分とに分割されており、この場合、熱的な接続部分は第1の電気的な接続部分に挿入結合されており、ボンディングワイヤ接続範囲は第2の電気的な接続部分に形成されている。給電のためには、チップに設けられたコンタクト面からボンディングワイヤ接続範囲にまでワイヤ結合部が案内されている。

30

## 【0031】

本発明による構成素子を製造するための方法は、たとえば予めテープまたはシートから打抜き加工されている支持部分を準備することから出発する。

## 【0032】

次のステップでは、別個に製作された熱的な接続部分が、支持部分に設けられた対応する開口内に挿入結合される。その後に、熱的な接続部分には、たとえば導電性の付着剤を用いた接着またはろう付けによってチップが搭載される。こうして形成された導体フレームは、たとえば射出成形法またはトランスマルク成形法でハウジングを形成するための適当なハウジング成形材料で、このハウジング材料内に埋め込まれるように被覆される。

40

## 【0033】

射出成形による埋込み前に導体フレームにチップを搭載することには、このために高温方法、たとえばろう付け法を使用することができるという利点がある。予めハウジング部分が射出成形されていると、付着したハウジング部分がこのような温度では損傷されてしまう恐れがある。このことが問題とならない場合には、当然ながら、これらの方針を別々の順序で実施することもできる。

## 【0034】

射出成形による埋込み前に導体フレームにチップを搭載する場合、チップは特に260℃を超える温度で硬ろうを用いたろう付け法によって被着され得る。これによって、チップ

50

と導体フレームとの間に特に低い熱抵抗が達成される。さらに、チップと熱的な接続部分との間の極めて耐熱的な結合が形成され、特に最大約260°Cまでの典型的な温度での構成素子のろう付け固定時に、チップが剥離する危険が減じられる。

#### 【0035】

以下に、本発明の5つの実施例を図面につき詳しく説明する。

#### 【0036】

図1aおよび図1bに示したリードフレームもしくは導体フレーム2は、2つの電気的な接続部分（電気的端子）12a, 12bに分節された支持部分と、熱的な接続部分（熱端子）4とを有している。両電気的な接続部分12a, 12bは、それぞれ端部にろう付け接続ストリップ3a, 3bを有している。

10

#### 【0037】

第1の電気的な接続部分12aはアイの形の開口を有している。このアイ開口内には、熱的な接続部分4が挿入結合されている。このためには、たとえば熱的な接続部分4が第1の電気的な接続部分12aのアイ開口内に正確に嵌合するように嵌め込まれ、その後に一種のリバットの形で第1の電気的な接続部分12aとプレス締結される。熱的な接続部分4と第1の電気的な接続部分12aとの間での折りたたみ周面側の結合、たとえばリバット締結、ろう付けまたは溶接による結合も同じく可能である。

#### 【0038】

熱的な接続部分4は、ほぼ回転対称的に形成されていて、突出部19を有している。これらの突出部19はハウジング内での導体フレーム2の安定したアンカ固定を可能にする。さらに、熱的な接続部分4には、バスタブ形リフレクタ（Relektorwanne）16の形の中心の凹部が形成されている。このバスタブ形リフレクタ16の底面には、放射線を発するチップを収容するためのチップ搭載範囲11が設けられている。凹部の側面は反射面として働く。

20

#### 【0039】

第1の電気的な接続部分12aのアイを形成するリングは切欠き13を有している。この切欠き13には、第2の電気的な接続部分12bに設けられた、舌片状に形成されたポンディングワイヤ接続範囲10がオーバラップしている。このポンディングワイヤ接続範囲10はバスタブ形リフレクタ16の放射側の縁部に対して高さをずらされて配置されている。このことはチップ搭載時に、熱的な接続部分4に設けられたバスタブ形リフレクタの縁部に切欠きを設ける必要なしに、チップとポンディングワイヤ接続範囲10との間の短いワイヤ結合部を可能にする。

30

#### 【0040】

図2には、本発明によるハウジングの1実施例の縦断面を示す斜視図が示されている。このハウジングは、プラスチック成形材料から成るハウジングベースボディ1を有している。このハウジングベースボディ1は、たとえば射出成形法またはトランプスファ成形法によって製造されていてよい。この成形材料は、たとえばエポキシ樹脂またはアクリル樹脂を主体としたプラスチック材料から成っているが、しかしこの目的のために適した材料であればいかなる材料から成っていてもよい。

40

#### 【0041】

ハウジングベースボディ1内には、ほぼ図1に示した導体フレームに相当する導体フレーム2、つまり2つの電気的な接続部分12a, 12bと、第1の電気的な接続部分12a内に挿入結合された熱的な接続部分4と、ろう付け接続ストリップ3a, 3bとを備えた導体フレーム2が埋め込まれている。この場合、ろう付け接続ストリップ3a, 3bはハウジングベースボディ1から突出している。チップ搭載範囲11の側では、熱的な接続部分4が、バスタブ形リフレクタなしに十分に平坦に形成されている。

#### 【0042】

熱的な接続部分4はこの場合、この熱的な接続部分4の底面6がベースボディ載置面7の一部を形成するようにハウジングベースボディ1内に配置されている。ハウジングベースボディ1内での機械的に安定した固定のためには、熱的な接続部分4が、周面側に配置さ

50

れた突出部 19 を備えている。

#### 【0043】

ハウジングベースボディ 1 の、截置面 7 とは反対の側には、放射線出射窓として切欠き 8 が成形されている。この切欠き 8 は熱的な接続部分 4 に設けられたチップ搭載範囲 11 に通じているので、チップ搭載範囲 11 に固定したい、放射線を発するチップは放射線出射窓もしくは切欠き 8 内に位置している。放射線出射窓 8 の側面 9 は斜めに形成されていて、作動時にこのチップにより形成された放射線のためのリフレクタとして働く。

#### 【0044】

図 3 には、本発明によるハウジングの別の実施例による截置面の斜視図が示されている。前で説明した実施例の場合と同様に、熱的な接続部分 4 の底面 6 はハウジングベースボディ 1 から導出されている。この場合、熱的な接続部分 4 の底面 6 はハウジングベースボディ 1 から少しだけ突出しているので、組み込まれた状態では、確実な截置および熱的な接続部分 4 と、対応する支持体、たとえばプリント配線板またはヒートシンクとの間での良好な熱伝達が保証されている。

10

#### 【0045】

前で説明した実施例とは異なり、図 3 の実施例ではハウジングベースボディ 1 が、熱的な接続部分 4 からハウジングベースボディ 1 の側面に向かって延びる側方の溝 20 を有している。ハウジングが支持体上に組み付けられると、この溝 20 は組み込まれた状態においてもハウジングと支持体との間の結合のコントロールを可能にする。特にこれによつて、支持体と熱的な接続部分 4 との間のろう付け結合を検査することができる。

20

#### 【0046】

図 4 には、本発明による放射線を発する構成素子の 1 実施例を示す斜視図が示されている。

#### 【0047】

前で説明した実施例の場合と同様に、ハウジングベースボディ 1 内には、導体フレーム 2 と、この導体フレーム 2 内に挿入結合された熱的な接続部分 4 とが十分に埋め込まれているので、ろう付け接続ストリップ 3a、3b だけが側方でハウジングベースボディ 1 から突出している。熱的な接続部分 4 はハウジングベースボディ 1 の截置面 7 の一部を形成していて（図示しない）、こうして外部から熱的に接続可能である。

30

#### 【0048】

熱的な接続部分 4 のチップ搭載範囲 11 には、放射線を発するチップ 5、たとえば発光ダイオードが固定されている。このことは、硬ろうによって熱的な接続部分 4 にろう付けされている半導体チップ、たとえば LED チップまたはレーザチップであると有利である。択一的には、このチップが、十分な熱伝導率を有しかつ有利には導電性をも有する付着剤を用いて、チップ搭載範囲 11 に接着されていてもよい。

#### 【0049】

効率の良い放射線源のためには、特に GaAs、GaP および GaN を主体とした半導体材料、たとえば GaAlAs、InGaAs、InGaN および InGaAlP、GaN、GaAlN、InGaN および InGaN が適している。

40

#### 【0050】

構成素子のハウジングは、図 2 もしくは図 3 に示したハウジングにはほぼ相当しているが、図 2 もしくは図 3 に示したハウジングとは異なり、熱的な接続部分 4 はチップ 5 を取り囲むバスタブ形リフレクタ 16 を有している。このバスタブ形リフレクタ 16 の反射面は、ほぼシームレスに放射線出射窓 8 の側面 9 へ移行しているので、熱的な接続部分 4 により形成された部分範囲と、放射線出射窓 8 の側面 9 により形成された部分範囲とから構成されたりフレクタ全体が形成される。

#### 【0051】

さらに、放射線出射窓 8 は構成素子の長手方向で少しだけ拡張されていて、導体フレーム 2 の、熱的な接続部分 4 に結合されていない方の第 2 の電気的な接続部分 12b にボンディングワイヤ接続範囲 10 を有している。このボンディングワイヤ接続範囲 10 からは、

50

ワイヤ結合部 17 が導出されており、このワイヤ結合部 17 は、チップ 5 に被着されたコンタクト面にまで案内されている。

#### 【0052】

ポンディングワイヤ接続範囲 10 は、熱的な接続部分 4 のバスタブ形リフレクタ 16 の放射側の縁部に対して高さをずらされて配置されている。このことは、チップ 5 とポンディングワイヤ接続範囲 10 との間での短いワイヤ結合部、ひいては機械的に安定したワイヤ結合部を可能にする。なぜならば、ポンディングワイヤ接続範囲 10 をチップ 5 の近傍にまで近付けることができるからである。さらに、これによって、形成されたワイヤ円弧の高さも小さく保持され、こうして、たとえばチップを封止用の流込み材料によってカバーする際にワイヤ結合部が熱的な接続部分 4 に向かって側方に傾倒してしまうことにより生じる短絡の危険が減じられる。

#### 【0053】

図 5 には、本発明による構成素子のさらに別の実施例が横断面図で示されている。図 5 の横断面図は、図 4 に書き込まれた A-A 線に沿った断面図に相当する。

#### 【0054】

図 3 に示した実施例の場合と同様に、熱的な接続部分 4 はチップ 5 のための搭載面側の真ん中で四設されているので、チップ 5 により形成された放射線のためのバスタブ形リフレクタ 16 が形成されている。このバスタブ形リフレクタ 16 には、放射線出射窓 8 のリフレクタ側壁 9 が続いている。

#### 【0055】

前記実施例とは異なり、こうして形成されたリフレクタ全体 15 は部分リフレクタ 9、16 の間の移行部に屈曲部を有している。このような形状付与に基づき、回転放物面へのリフレクタ全体 15 の、改善された近似が達成され、ひいては有利な放射特性が達成される。チップからバスタブ形リフレクタ 16 の底面に対して、より急峻な角度で放射された光線は、構成素子の主放射方向 27 へ向かって、より強力に変向される。

#### 【0056】

チップを保護するためには、放射線出射窓 8 が封止用の流込み材料 14、たとえばエボキシ樹脂またはアクリル樹脂のような反応樹脂で充填されている。形成された放射線を集束させるためには、流込み材料 14 が、軽度に湾曲させられた表面 18 を備えたレンズとして成形されていてよい。

#### 【0057】

流込み材料 14 とハウジングベースボディ 1 と導体フレーム 2 との機械的に安定した結合を得るためにには、熱的な接続部分 4 のバスタブ形リフレクタ 16 の高さ A を、チップ 5 の高さ H の 2 倍よりも小さく設定することが有利である。熱的な接続部分 4 とハウジングベースボディ 1 とにより形成されたリフレクタ全体 15 の高さ B は、チップ 5 の高さ H の 4 倍よりも小さく設定されていることが望ましい。さらに、流込み材料 14 の容積 V については上で挙げた関係：

$$V \leq q \cdot H$$

が満たされるように放射線出射窓 8 を成形することが有利である。この場合、q は約 7 m m<sup>2</sup> である。この条件を満たすことにより、構成素子の機械的な安定性、ひいては負荷耐性および寿命が高められるので有利である。熱的な接続部分 4 を突出部 19 によってハウジングベースボディ 1 に固定することも、同じくこのために寄与する。

#### 【0058】

このような構成素子を製造するためには、まず導体フレーム 2 のために、たとえば支持テープから打ち抜かれた、開口を備えた支持部分が準備される。その後に、この支持部分の開口内に熱的な接続部分 4 が挿入されて、支持部分とプレス締結される。

#### 【0059】

次のステップで、熱的な接続部分 4 に放射線を発するチップ 5 が、たとえろうう付けまたは接着により被着される。ハウジングベースボディ 1 を形成するために、支持部分と熱的な接続部分 4 とから形成された導体フレーム 2 は、前搭載されたチップ 5 と共に成形材料

10

20

30

40

50

によって被覆される。ただしこの場合、成形材料による被覆は、チップ5を取り囲む範囲ならびにポンディングワイヤ接続範囲10を空けておくように行われる。このような被覆は、たとえば射出成形法またはトランスマルク成形法で行うことができる。最後に、ポンディングワイヤ接続範囲10からワイヤ結合部17がチップ5のコンタクト面にまで案内される。

#### 【0060】

次一的には、支持部分と熱的な接続部分4との結合の後に、こうして形成された導体フレーム2をまず最初に成形材料によって被覆し、その後に有利には接着によりチップ搭載範囲11にチップ5を固定して、コンタクトすることができる。

#### 【0061】

当然ながら、本発明は上で説明した実施例に限定されるものではない。さらに、本発明による導体フレームおよびハウジングは、有効な放熱を必要とする別の構成素子のためにも使用され得るか、もしくはチップとして別の半導体が使用され得る。

#### 【0062】

上で説明した方法、つまり導体フレームを準備し、かつ導体フレームを成形材料で被覆する前に有利にはろう付けによりチップを装着し、しかも導体フレームを成形材料で被覆する際にはチップ周辺部を空けておくという各方法ステップを包含する方法は、熱的な接続部分を有しない別のハウジング構造にも転用可能であり、それ自体既に発明を成すものである。

#### 【0063】

この方法の利点は特に次の点に認められる。すなわち、チップの固定が成形材料の性質とは十分に無関係に最適化され得る。ろう付けプロセスは、たとえば拡張された温度領域内で行うことができる。この場合、極めて小さな熱抵抗を持ってチップと導体フレームとの間の結合を形成する、有利には260°Cを超える溶融温度を有するろう、たとえば硬ろうを使用することができる。さらにこれによって、相応する構成素子をプリント配線板にろう付けにより装着する際にチップが剥離してしまう危険も減じられる。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【0064】

【図1a】本発明による導体フレームの1実施例を示す概略的な平面図である。

#### 【0065】

【図1b】本発明による導体フレームの1実施例を示す概略的な断面図である。

#### 【0066】

【図2】本発明によるハウジングの第1実施例を示す概略的な斜視断面図である。

#### 【0067】

【図3】本発明によるハウジングの第2実施例を示す概略的な斜視図である。

#### 【0068】

【図4】本発明による構成素子の第1実施例を示す概略的な斜視図である。

#### 【0069】

【図5】本発明による構成素子の第2実施例を示す概略的な横断面図である。

10

20

30

## 【国際公開パンフレット】

**(II) NACH DEM VERTRÄG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG**



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
24. Oktober 2002 (24.10.2002)



PCT



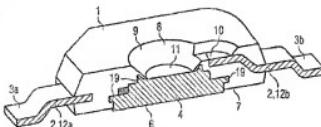
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 02/084749 A2**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| (3) Interessenten-Präferenzkennzahl(en)                                | 10011_3390                              | (4) Erfordert und<br>(5) Erfordert/kannst (nur für USD BOGNER, Georg<br>Klaus und für EUR BÖHM, Stephan)                        |
| (3) Interessenten-Alternativen   | PC1/3/35/001/065                        |   |
| (3) Interessenten-Auskunftszeitraum                                    | 9. April 2000 (99/04/2000)              | Erfordert/kannst (nur für EUR BÖHM, Stephan)<br>Erfordert/kannst (nur für USD BOGNER, Georg<br>Klaus und für EUR BÖHM, Stephan) |
| (4) Bar-/Buchungssprache   | Deutsch                                 |   |
| (5) Veröffentlichungssprache   | Deutsch                                 |   |
| (6) Angabe zur Priorisierung   | 10 - 15 %                               | (4) Jeder: ERFMANN & FISCHER, Berlin<br>strasse 55, 10557 Berlin  |
| (7) Datum der Antragstellung   | 30. April/2000 (99/04/2000)             |   |
| (8) Anwender (nur für EUR BÖHM, Stephan / für USD BOGNER, Georg Klaus) | OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH & CO. KG | (4) Börsennotierte Unternehmen (nur für USD BOGNER, Georg<br>Klaus und für EUR BÖHM, Stephan)                                   |

© Blackwell Publishers Ltd. 2001



卷之三



- (7) Abstand. Die Abstandshöhe ist in einer Konstruktion (7) und einer Baulinie, in addition zu einer verdeckten Längsunterstützung (8), eine horizontale Abstandshöhe, die für die Produktion eines Produktes (9) benötigt wird, um eine Linie Herstellung zu ermöglichen, die die Produktion von Produkten (9) auf einer Baulinie (10) mit einer Länge von  $L$  und einer Breite von  $B$  auf einer Basisfläche (11) ermöglicht, wobei die Basisfläche (11) eine horizontale Abstandshöhe (12) aufweist, um eine Längsunterstützung (8) unter der Basisfläche (11) zu ermöglichen, um die Basisfläche (11) auf einer Basisfläche (11) zu unterstützen. In order to form the basis, the distance (7) is composed with a modular system (13), so that a user can, in a simple way, have the distance (7) customized from the outside.

(8) Zusammenfassung. Ein Verfahren herstellendes, dass eine Längsunterstützung (8) unter einer Basisfläche (11) positioniert wird, um eine horizontale Abstandshöhe (12) zu gewährleisten, die die Basisfläche (11) auf einer Basisfläche (11) unterstützt, um eine Längsunterstützung (8) unter einer Basisfläche (11) zu ermöglichen, um die Basisfläche (11) auf einer Basisfläche (11) zu unterstützen, bestehend aus: (i) Anordnen einer Längsunterstützung (8) unter einer Basisfläche (11), wobei die Basisfläche (11) eine horizontale Abstandshöhe (12) aufweist, um eine Längsunterstützung (8) unter der Basisfläche (11) zu ermöglichen, um die Basisfläche (11) auf einer Basisfläche (11) zu unterstützen; (ii) Anordnen eines Abstandsbaus (13) über der Basisfläche (11), wobei die Basisfläche (11) eine horizontale Abstandshöhe (12) aufweist, um eine Längsunterstützung (8) unter der Basisfläche (11) zu ermöglichen, um die Basisfläche (11) auf einer Basisfläche (11) zu unterstützen; (iii) Anordnen einer Längsunterstützung (8) unter einer Basisfläche (11), wobei die Basisfläche (11) eine horizontale Abstandshöhe (12) aufweist, um eine Längsunterstützung (8) unter der Basisfläche (11) zu ermöglichen, um die Basisfläche (11) auf einer Basisfläche (11) zu unterstützen.

---

WO 02/084749 A2 

## Veröffentlichung:

— über internationale Rechtsgerichte und seinen zu ermöglichen nach Fehl der Berechtigung

Zur Erläuterung der Bernhardshausen-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erläuterungen ("Guide Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gesetze verwiesen.

## Beschreibung

Leiterrahmen und Gehäuse für ein strahlungsmittelndes Bauelement, strahlungsmittelndes Bauelement sowie Verfahren  
5 zu dessen Herstellung

Die Erfindung betrifft einen Leiterrahmen nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1, ein Gehäuse nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 14, ein strahlungsmittelndes Bauelement nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 23 sowie ein Verfahren 10 zu dessen Herstellung nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 33.

Leiterrahmen für strahlungsmittelnde Halbleiterbauelemente 15 sind beispielsweise aus DE 196 36 454 bekannt. Die hierin beschriebenen Halbleiterbauelemente weisen einen Gehäusegrundkörper mit darin eingebetteten Leiterrahmen sowie einen strahlungsmittelnden Halbleiterkörper auf, der auf den Leiterrahmen montiert ist. Der Leiterrahmen und der Gehäusegrundkörper sind zugleich als Reflektor für die erzeugte Strahlung ausgebildet.

Weiterhin sind aus dem Gehäusegrundkörper ragende Teilebereiche des Leiterrahmens als externe elektrische Anschlußstellen 25 gebildet und ist das Gehäuse so geformt, daß das Bauelement nur Oberflächenmontage geeignet ist. Um eine gute Ableitung der entstehenden Verlustwärme, insbesondere bei Halbleiterbauelementen mit hoher Leistung, zu erreichen, kann ein Teil des Reflektors als thermischer Anschluß aus dem Gehäusegrundkörper herausgeführt sein.

Bei Bauelementen mit hohen optischen Leistungen und entsprechend großen Verlustleistungen ist eine noch effizientere Art der Wärmeableitung wünschenswert beziehungsweise erforderlich.  
35

2

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, bei strahlungs-emittierenden Bauelementen eine verbesserte Wärmeableitung zu schaffen, die insbesondere die Herzeugung hoher optischer Leistungen im Bauelement zuläßt. Weiterhin ist ein Aufgabe der 5 Erfindung, ein Herstellungsvorfahren hierfür anzugeben.

Diese Aufgabe wird durch einen Leiterrahmen gemäß Patentanspruch 1, ein Gehäuse gemäß Patentanspruch 14, ein strahlungsemittierendes Bauelement gemäß Patentanspruch 23 berücksichtigende ein Vorfahren gemäß Patentanspruch 33 gelöst. Verteilbare Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

Erfindungsgemäß ist vorgesehen, einen Leiterrahmen für ein strahlungsemittierendes Bauelement, bevorzugt eine Lichenelektronische Diode, mit mindestens einem Chipmontagebereich, mindestens einem Drahtanschlußbereich und mindestens einem externen elektrischen Anschlußstreifen, beispielsweise zum Montieren und elektrischen Anschließen des Bauelements auf einer 15 Leiterplatte, auszubilden, wobei ein Trägerteil vorgesehen ist, das den Drahtanschlußbereich und den elektrischen Anschlußstreifen aufweist und in das ein getrennt vom übrigen Leiterrahmen separat gefertigtes thermisches Anschlußteil eingeklebt ist, auf dem der Chipmontagebereich angeordnet 20 ist. Bei einem Bauelement mit einem darartigen Leiterrahmen wird die im Betrieb entstehende Verlustwärme vor allem über das thermische Anschlußteil abgeführt. Vorgezogene ist das thermische Anschlußteil mit dem Trägerteil elektrisch leitend verbunden und dient gleichzeitig als elektrischer Anschluß 25 für den Chip.

Das separat von dem übrigen Leiterrahmen gefertigte thermische Anschlußteil weist dabei den Vorteil auf, daß es wesentlich besser hinsichtlich Aufnahme und Ableitung größerer Verlustwärmemengen optimiert werden kann als ein einstöckiger Leiterrahmen. So kann bei einem solchen thermischen Anschlußteil die Dicke, die Wärmeleitfähigkeit, der thermische Aus-

3

dehnungskoeffizient und die thermische Anschlußfläche weitestgehend unabhängig von den Anforderungen an den übrigen Leiterrahmen optimiert werden. Insbesondere kann bei dem thermischen Anschlußteil vorteilhafterweise eine hohe Wärmekapazität erreicht werden, so daß das thermische Anschlußteil eine effiziente Wärmeanreiche bildet. Eine große thermische Anschlußfläche verringert den Wärmeübergangswiderstand und verbessert so die Wärmeleitung und die Wärmeabgabe an die Umgebung.

10

Bei einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung weist das Trägerteil eine Einlegeöffnung, beispielsweise in Form einer Flammer oder Öse, auf, in die das thermische Anschlußteil eingekröpft ist. Hierunter ist zu verstehen, daß das thermische Anschlußteil in die Einlegeöffnung des Leiterrahmens eingesetzt und umfangreich mit dem Leiterrahmen verbunden ist.

Dazu kann das thermische Anschlußteil in das Trägerteil beispielweise geklemmt und/oder mit diesem vergeschobt oder vernietet sein. Bevorzugt wird bei der Erfindung eine Quetschverbindung zwischen dem thermischen Anschlußteil und dem Trägerteil gebildet, die sich durch hohe mechanische Festigkeit und gute elektrische Leitfähigkeit auszeichnet. Ein Quetschverbindung kann beispielsweise dadurch gebildet werden, daß das Trägerteil und das thermische Anschlußteil zueinander positioniert werden, beispielsweise durch Einlegen des Anschlußteils in eine Einlegeöffnung des Trägerteils, und dann das thermische Anschlußteil derart verformt wird, daß ein mechanisch fester Sitz des Anschlußteils im Trägerteil entsteht. Zur Verformung kann ein hammer- oder stempelartiges Werkzeug verwendet werden.

Bevorzugt ist das Anschlußteil so geformt, daß es nach Art einer Niete mit dem Trägerteil verbunden werden kann. Gegebenenfalls genügt auch die Verformung einzelner Stegs oder Streben des Anschlußteils, um eine Quetschverbindung

4

ausreichender Festigkeit zwischen dem Anschlußteil und dem Trägerteil zu bilden.

Im Rahmen der Erfindung können zusätzlich oder alternativ 5 anderweitige Verbindungen zwischen dem Anschlußteil und dem Trägerteil vorgesehen sein. Beispielsweise ist eine Löt- oder Schweißverbindung hierfür geeignet. Weiterhin kann das Anschlußteil mit dem Trägerteil verklebt sein.

10 Mit Vorteil wird so ein mechanisch stabiles Gerät für das Halbleiterbauelement gebildet, das mit vergleichsweise geringem technischen Aufwand herstellbar ist.

Bevorzugt weist das thermische Anschlußteil eine Reflektor- 15 wanne auf. Bei einem damit gebildeten Bauteil verbessert das thermische Anschlußteil die Strahlungsausbeute und die Strahlhöndelung des Bauteils. Bei dieser Weiterbildung der Erfindung wird vorzugsweise ein metallisches thermisches An- schlußteil verwendet, da sich Metallflächen aufgrund geringer 20 Absorptionsverluste und einer stark gerichteten, gegebenenfalls spiegelnden Reflexion sehr gut als Reflektorfächen eignen.

Zur Erhöhung der mechanischen Stabilität, insbesondere bei 25 einem im folgenden noch genauer erläuterten Gehäuse bzw. Bauteil, ist es vorteilhaft, die Höhe der Reflektortwanne des thermischen Anschlußteils so zu bemessen, daß sie die doppelte Höhe des zur Anordnung auf dem Chipmontagebereich vorgesehe- 30 nen Chips nicht übersteigt.

Als Material für das thermische Anschlußteil eignen sich auf- 35 grund der hohen Wärmeleitfähigkeit Metalle, insbesondere Kupfer oder Aluminium oder hieraus gebildete Legierungen. Weiterhin bevorzugt Materialien sind Molybdän, Eisen, Nickel und Wolfram sowie Nickel-Eisen- und Kupfer-Wolfram-Legierungen, deren thermischer Ausdehnungskoeffizient gut an den thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Halbleitermaterialien wie

5

beispielsweise GaAs, GaN und darauf basierenden Systemen, angepaßt ist. Weiter eignen sich als Material für das thermische Anschlußteil Keramiken und Halbleiter wie beispielsweise Silizium. Das thermische Anschlußteil kann auch mehrlagig, beispielsweise als Metall-Keramik-Verbundsystem gebildet sein.

Bevorzugt ist die Chipmontagefläche des thermischen Anschlußteils mit einer Vergütung versehen, die die Oberflächenegenschaften hinsichtlich der Aufbringung eines Chips (Rohreigenschaften) verbessert. Diese Vergütung kann beispielsweise eine Silber- oder Goldbeschichtung umfassen.

Weitersgehend ist es vorteilhaft, auch den Lötschlußteifen bzw. den Bonddrahtanschlußbereich mit einer die Löt- bzw. Bondigenschaften verbessерnden Oberflächenvergütung, beispielsweise einer Au-, Ag-, Sn- oder In-Beschichtung, zu versehen.

10 Das Trägerteil enthält vorzugsweise Kupfer oder Weichsilber und kann beispielsweise aus entsprechenden Folien gestanzt werden. Mit Vorteil dient das Trägerteil bei der Erfindung nicht der Wärmeableitung und kann daher für die Funktion der Stromversorgung sowie hinsichtlich seiner Biegeigenschaften und Haftung einer im folgenden noch genauer beschriebenen Formmasse optimiert werden.

15 Dies umfaßt beispielsweise, daß das Trägerteil in seiner Dicke so ausgeführt ist, daß es aus einem Trägerband von der Rolle gefertigt, leicht gestanzt und in Form gebogen werden kann. Derartige Verarbeitungseigenschaften erlauben mit Vorteil eine automatisierte Fertigung und eine dichte Anordnung (geringer Pitch) der Einzelkomponenten auf dem Trägerband.

20 Die hierfür erforderliche geringe Dicke des Trägerteils erschwert in der Regel eine ausreichende Kühlung des Chips. Insbesondere ist aus Gründen der mechanischen Stabilität der

Querschnitt eines thermischen Anschlusses begrenzt. Dieser Nachteil wird bei der Erfindung durch das eingeprägte thermische Anschlußteil behoben.

- 5 Bevorzugt ist bei der Erfindung zur Ausbildung eines Gehäuses für ein strahlungsausstörendes Bauelement der Leiterrahmen von einem Gehäusegrundkörper umschlossen. Vorgezogeneweise ist dazu der Leiterrahmen in eine den Gehäusegrundkörper bildende Formmasse, beispielsweise eine Spritzguss- oder Spritzpreßmasse eingebettet. Dies erlaubt eine kostengünstige Herstellung des Gehäuses im Spritzguss- oder Spritzpreßverfahren. Die Formmasse besteht beispielsweise aus einem Kunststoffmaterial auf der Basis von Epoxidharz oder Acrylharz, kann aber auch aus jedem anderen für den vorliegenden Zweck geeigneten Material bestehen. Zur Wärmeableitung ist es vorteilhaft, das thermische Anschlußteil so einzubetten, daß es teilweise aus dem Gehäusegrundkörper ragen oder einen Teil von dessen Oberfläche bildet und somit von außen thermisch anschließbar ist.
- 10 15 20 25
- Vorgezogeneweise ist in dem Gehäusegrundkörper eine Ausnehmung in Form eines Strahlungsausstittfensters gebildet und das thermische Anschlußteil darin in den Gehäusegrundkörper eingebettet, daß der Chipmontagebereich innerhalb des Strahlungsausstittfensters angeordnet ist. Beispielsweise kann der Chipmontagebereich eine Begrenzungsfäche des Strahlungsausstittfensters bilden.
- Diese Gehäuseform eignet sich insbesondere für oberflächenmontierbare Bauelemente, wobei die den Strahlungsausstittfenster gegenüberliegenden Seite oder eine Seitenfläche des Gehäusegrundkörpers eine Auflagefläche des Bauelements bildet. Bevorzugt erstreckt sich das eingegebettete thermische Anschlußteil bis zu dieser Auflagefläche, so daß über die Auflagefläche zugleich die Verlustwärme, beispielsweise an einen Kühlkörper oder ein PCB (printed circuit board, Leiterplatte) abgeführt wird. Dabei ist es vorteilhaft, das thermische An-

WO 03/084749

PCT/DE02/0106

7

schlußteil so auszuführen, daß ein Teil seiner Oberfläche zugleich die Auflagefläche oder eine Teilläche hiervon bildet.

Zur Steigerung der Strahlungsausbeute kann das Strahlungsaustrittsfenster im Gehäusegrundkörper konisch geformt sein, so daß dessen Seitenwände einen Reflektor bilden. Durch diesen Reflektor können von einer auf dem Chipmontagebereich befindlichen Strahlungsquelle nur Seite emittierte Strahlungsanteile zur Hauptstrahlungsrichtung hin wegelektzt werden.  
10 Damit wird eine Erhöhung der Strahlungsausbeute und eine verbesserte Bündelung der Strahlung erreicht.

Vorteilhaft ist bei dem Reflektor eine Formgebung, bei der das thermische Anschlußteil einen ersten Teilbereich des Reflektors bildet, an dem sich ein zweiter, von den Seitenwänden des Strahlungsaustrittsfensters geformter Reflektorteilbereich anschließt. Bevorzugt ist die Gesamthöhe des Reflektors geringer als die vierfache Höhe eines zur Befestigung auf dem Chipmontagebereich vorgesehenen Chips. Dies gewährleistet eine hohe mechanische Stabilität und limitiert die aufgrund von Temperaturänderungen auftretenden Spannungen, wie sie beispielsweise bei Lötzprozessen entstehen, auf ein tolerables Maß.

25 Bei der Erfindung ist weiter vorgesehen, mit einem erfundungsgemäßen Leiterrahmen oder Gehäuse ein strahlungsemitwendendes Bauelement mit verbesselter Wärmeableitung zu bilden. Ein solches Bauelement weist einen strahlungsemitwendenden Chip, vorzugsweise einen Metallleiterchip, auf, der auf dem Chipmontagebereich des thermischen Anschlußteils angeordnet ist.

Bevorzugt ist der Chip zumindest teilweise von einer Vergußmasse umhüllt. Besonders bevorzugt ist diese Ausführungsform 35 für Gehäuse mit einem in einem Strahlungsaustrittsfenster angeordneten Chip, wobei das Strahlungsaustrittsfenster ganz oder teilweise mit der Vergußmasse gefüllt ist. Als Verguß

WO 03/064749

PCT/DE02/0306

8

eignen sich insbesondere Reaktionsharze wie beispielsweise Epoxidharze, Acrylharze oder Siliconharze oder Mischungen hierzu. Weitergehend können dem Verguß Leuchtmstoffe zugesetzt sein, die die von dem Chip erzeugte Strahlung in einen anderen Wellenlängenbereich konvertieren. Diese Ausführungsform eignet sich insbesondere für mischfarbiges oder weißes Licht abstrahlende Bauelement.

Um thermische Verspannungen zwischen Gehäuse, Chip und Verguß 10 gering zu halten und insbesondere eine Delamination der Vergußabdeckung zu verhindern, ist es vorteilhaft, das Vergußvolumen  $V$  so zu wählen, daß bemöglich der Höhe  $H$  des Chips die Relation

15  $V \leq q \cdot H$ 

erfüllt ist. Dabei bezeichnet  $q$  einen Skalierungsfaktor, dessen Wert kleiner als  $10 \text{ mm}^2$  ist und vorzugsweise  $7 \text{ mm}^2$  beträgt.

20 Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist der Leiterrahmen in ein erstes und ein zweites elektrisches Anschlußteil gegliedert, wobei das thermische Anschlußteil in das erste elektrische Anschlußteil eingeknüpft und der Bonddrahtanschlußbereich auf dem zweiten elektrischen Anschlußteil ausgebildet ist. Zur elektrischen Versorgung ist von einer Kontaktfläche des Chips eine Drahtverbindung zu dem Bonddrahtanschlußbereich geführt.

25 Ein Verfahren zur Herstellung eines erfindungsgemäßen Bauelements beginnt mit der Bereitstellung eines Trägerteiles, das beispielsweise zuvor aus einem Band oder einer Folie gestaut wurde.

30 Im nächsten Schritt wird ein separat gefertigtes thermisches Anschlußteil in eine dafür vorgesehene Öffnung des Träger- teils eingeknüpft. Nachfolgend wird der Chip auf das thermal-

WO 03/084749

PCT/DE03/0106

9

9  
sche Anschlußteil montiert, beispielsweise durch Aufkleben  
mittels eines elektrisch leitfähigen Haftmittels oder durch  
Auflöten. Abschließend wird der so gebildete Leiterrahmen mit  
einer geeigneten Gehäuseformmasse zur Ausbildung des Gehäuses  
5 umhüllt, beispielsweise in einem Spritzguß- oder Spritzpreß-  
verfahren.

Die Montage des Chips auf den Leiterrahmen vor dem Umspritzen  
hat den Vorteil, daß hierfür auch Hochtemperaturverfahren,  
10 beispielsweise Lötarbeiten, angewendet werden können. Angespritzte  
Gehäuseteile könnten bei derartigen Temperaturen  
beschädigt werden. Falls dies nicht relevant ist, können die  
Verfahrensschritte selbstverständlich auch in anderer Reihen-  
folge durchgeführt werden.

15 15 Bei einer Montage des Chips auf den Leiterrahmen vor dem Umspritzen kann der Chip insbesondere bei Temperaturen über  
260°C mittels eines Hartlötzverfahrens aufgebracht werden. Da-  
mit wird ein besonders niedriger Wärmedurchgangswiderstand zwischen  
20 Chip und Leiterrahmen erreicht. Zudem wird eine sehr tempera-  
turbeständige Verbindung zwischen Chip und thermischen An-  
schlußteil geschaffen und insbesondere beim Einlöten des Bau-  
elements bei typischen Temperaturen bis etwa 260°C die Gefahr  
einer Ablösung des Chips verringert.

25 25 Weitere Merkmale, Vorteile und Zweckmäßigkeit der Erfindung  
werden nachfolgend anhand von fünf Ausführungsbeispielen in  
Verbindung mit den Figuren 1 bis 5 erläutert.

30 30 Es zeigen

Figur 1a und 1b eine schematische Ansicht bzw. Schnittan-  
sicht eines Ausführungsbeispiels eines erfindungs-  
35 genüßen Leiterrahmens,

Figur 2 eine schematische, perspektivische Schnittansicht  
eines ersten Ausführungsbeispiels eines erfindungs-

10

gemäßem Gehäuses,

Figure 3 eine schematische, perspektivische Ansicht eines zweiten Ausführungsbeispiels eines erfundungsgemäßen Gehäuses,

Figure 4 eine schematische, perspektivische Ansicht eines ersten Ausführungsbeispiels eines erfundungsgemäßen Bauelements und

Figure 5 einen schematischen Querschnitt eines zweiten Ausführungsbeispiels eines erfundungsgemäßen Bauelements.

15 Der im Figure 1a und 1b dargestellte Leiterrahmen 2 umfasst ein in zwei elektrische Anschlußteile 12a,b gegliedertes Träger-  
teil sowie ein thermisches Anschlußteil 4. Die beiden elek-  
trischen Anschlußteile 12a,b enden jeweils in einem Lötan-  
schlußstreifen 3a,b.

20 Das eine elektrische Anschlußteil 12a weist eine Öffnung in Form einer Öse auf. In die Ösenöffnung ist das thermische An-  
schlußteil 4 eingeknüpft. Dazu kann beispielsweise das ther-  
mische Anschlußteil 4 präzise in die Ösenöffnung des elek-  
trischen Anschlußteils 12a eingelebt und nachfolgend nach Art  
25 einer Niete mit dem elektrischen Anschlußteil 12a vergossen werden. Alternative umfangsseitige Verbindungen zwischen den thermischen 4 und dem elektrischen Anschlußteil 12a, bei-  
spielsweise durch Vernieten, Verlöten oder Verschweißen, sind  
30 ebenfalls möglich.

Das thermische Anschlußteil 4 ist in wesentlichen rotations-  
symmetrisch und weist Vorsprünge 19 auf, die eine stabile Ver-  
ankerung des Leiterrahmens 2 in einem Gehäuse ermöglichen.

35 Weiterhin ist in dem thermischen Anschlußteil 4 eine zentri-  
sche Einsenkung in Form einer Reflektorwanne 16 gebildet, auf  
deren Bodenfläche ein Chipmontagebereich 11 zur Aufnahme ei-

WO 03064749

PCT/DE03/01306

11

nes strahlungssättigenden Chips vorgesehen ist. Die Seitenflächen der Einsenkung dienen als Reflektorflächen.

Der Übergang des elektrischen Anschlußteils 12a weist eine 5 Ausprägung 13 auf, mit der ein zungenförmig gestalteter Bonddrahtanschlußbereich 10 des zweiten elektrischen Anschlußteils 12b überlappt. Dieser Bonddrahtanschlußbereich 10 ist höherenwertet zu dem abstrahlungsseitigen Rand der Reflektorenwand angeordnet. Dies ermöglicht bei der Chipmontage kurze 10 Drahtverbindungen zwischen Chip und Bonddrahtanschlußbereich 10, ohne daß hierfür eine Ausprägung am Rand der Reflektorenwand in dem thermischen Anschlußteil erforderlich ist.

In Figur 2 ist perspektivisch ein Längsschnitt durch ein Ausführungsbeispiel einer erfundsgewidrten Gehäuse dargestellt. Das Gehäuse weist einen Grundkörper 1 aus Kunststoffformasse auf, der beispielsweise mittels eines Spritzguß- oder Spritzpresverfahrens hergestellt sein kann. Die Formmasse besteht beispielsweise aus einem Kunststoffmaterial auf 15 der Basis von Epoxidharz oder Acrylharz, kann aber auch aus jedem anderen für den vorliegenden Zweck geeigneten Material bestehen.

In den Grundkörper 1 ist ein im wesentlichen Figur 1 entsprechender Leiterrahmen 2 mit zwei elektrischen Anschlußteilen 20 12a,b und einem darin eingekröpften thermischen Anschlußteil 4 sowie Lötschlußstreifen eingebettet, wobei letztere aus dem Gehäusegrundkörper herausragen. Auf der Seite des Chipanschlußbereichs 12 ist das thermische Anschlußteil 4 weitge- 30 hend plan ohne Reflektorenwand ausgebildet.

Das thermische Anschlußteil 4 ist dabei so innerhalb des Gehäusegrundkörpers 1 angeordnet, daß die Bodenfläche 6 des thermischen Anschlußteils 4 einen Teil der Grundkörpersauflagefläche 7 bildet. Zur mechanisch stabilen Verankerung in dem Gehäusegrundkörper ist das thermische Anschlußteil mit umfangsseitig angeordneten Vorsprüngen 19 versehen.

Der Auflagefläche 7 gegenüberliegend ist als Strahlungsaustrittsfenster eine Ausnehmung 8 in dem Gehäusegrundkörper geformt, die zu dem Chipmontagebereich 11 auf dem thermischen Anschlußteil 4 führt, so daß ein darauf zu befestigender strahlungsemittierender Chip sich innerhalb des Strahlungsaustrittsfensters 8 befindet. Die Seitenflächen 9 des Strahlungsaustrittsfensters 8 sind angeschrägt und dienen als Reflektor für die von einem solchen Chip im Betrieb erzeugte

10 Strahlung.

Figur 3 zeigt eine perspektivische Ansicht auf die Auflagefläche eines weiteren Ausführungsbeispiels eines erfundungsgemäßen Gehäuses. Wie bei dem zuvor beschriebenen Ausführungsbeispiel ist die Bodenfläche 6 des thermischen Anschlußteils 4 aus dem Gehäusegrundkörper 1 herausgeführt. Dabei ragt die Bodenfläche 6 des thermischen Anschlußteils 4 etwas aus dem Grundkörper 3 hervor, so daß in eingebautem Zustand eine sichere Auflage und eine gute Wärmeübertragung zwischen dem thermischen Anschlußteil 4 und einem entsprechenden Träger wie beispielsweise einer Leiterplatte oder einem Kühlerkörper gewährleistet ist.

Im Unterschied zu dem zuvor beschriebenen Ausführungsbeispiel weist der Gehäusegrundkörper 1 eine seitliche, von dem thermischen Anschlußteil 4 zu einer Seitenfläche des Gehäusegrundkörpers 1 verlaufende Nut 20 auf. Ist das Gehäuse auf einen Träger montiert, so erlaubt diese Nut 20 auch im eingebauten Zustand eine Kontrolle der Verbindung zwischen dem Gehäuse und dem Träger. Insbesondere kann damit eine Lötarbeitung zwischen dem Träger und dem thermischen Anschlußteil überprüft werden.

In Figur 4 ist eine schematische, perspektivische Ansicht eines Ausführungsbeispiels eines erfundungsgemäßen strahlungsemittierenden Bauelements gezeigt.

13

Nie bei dem zuvor beschriebenen Ausführungsbeispiel ist ein Leitertramen 2 mit einem eingeklopften thermischen Anschlußteil 4 weitgehend in den Gehäusegrundkörper 1 eingebettet, so daß lediglich die Lötschlußstreifen 3a,b seitlich aus dem 5 Gehäusegrundkörper 1 herausragen. Das thermische Anschlußteil 4 bildet in nicht dargestellter Weise einen Teil der Auflagefläche 7 des Gehäusegrundkörpers bildet und ist so von außen thermisch anschließbar.

10 Auf dem Chipmontagebereich 11 des thermischen Anschlußteils 4 ist ein strahlungsemittierender Chip 5 wie zum Beispiel eine Lichtwellenleiterdiode befestigt. Vorrangigweise ist dies ein Halbleiterchip, beispielsweise ein LED-Chip oder ein Laserchip, der mittels eines Hartlötens auf das thermische Anschlußteil 4 aufgelötet ist. Alternativ kann der Chip mit einem Haftmittel, das eine ausreichende Wärmeleitfähigkeit aufweist und vorzugsweise auch elektrisch leitfähig ist, auf dem Chipmontagebereich 11 aufgeklebt sein.

20 Für effiziente Strahlungsquellen eignen sich insbesondere Halbleitermaterialien auf der Basis von GaAs, GaP und GaN wie beispielsweise GaAlAs, InGaAs, InGaAlP, GaN, GaAlN, InGaN und InGaAlN.

25 Das Gehäuse des Bauelements entspricht im wesentlichen der in Figur 2 beziehungsweise 3 dargestellten Gehäuse. Im Unterschied hierzu weist das thermische Anschlußteil 4 eine den Chip 5 umgebende Reflektorenwanne 16 auf. Deren Reflektorflächen gehen im wesentlichen nahtlos in die Seitenflächen 9 des Strahlungsaustrittsfensters 8 über, so daß ein Gesamtreflektor entsteht, der sich aus einem von dem thermischen Anschlußteil 4 gebildeten Teilbereich und einem von den Seitenflächen 9 des Strahlungsaustrittsfensters 8 gebildeten Teilbereich zusammensetzt.

30 Weiterhin ist das Strahlungsaustrittsfenster 8 in der Längsrichtung des Bauelements etwas erweitert und umfaßt einen

WO 02004749

PCT/DE02/0196

14

Bonddrahtanschlussbereich 10 auf dem nicht mit dem thermischen Anschlußteil verbundenen elektrischen Anschlußteil 12b des Leiterrahmens 2. Von diesem Bonddrahtanschlussbereich 10 ist eine Drahtverbindung 17 zu einer auf dem Chip 5 aufgebrachten 5 Kontaktfläche geführt.

Der Bonddrahtanschlussbereich 10 ist höherversetzt zum abstrahlungsseitigen Rand der Reflektowanne 16 des thermischen Anschlußteils angeordnet. Dies ermöglicht eine kurze und da- 10 mit mechanisch stabile Drahtverbindung zwischen Chip 5 und Bonddrahtanschlussbereich 10, da letzterer nah an den Chip 5 herangeführt werden kann. Weiterhin wird dadurch die Höhe des entstehenden Drahtbogens gering gehalten und so die Gefahr eines Kurzschlusses, der beispielsweise bei einer Abdeckung 15 des Chips mit einem Verguß durch seitliches Umklappen der Drahtverbindung auf das thermische Anschlußteil entstehen könnte, reduziert.

In Figur 5 ist der Querschnitt eines weiteren Ausführungsbeispiel- 20 spieles eines erfindungsgemäßen Bauelements dargestellt. Der Schnittverlauf entspricht der in Figur 4 eingezeichneten Linie A-A.

Wie bei dem in Figur 3 gezeigten Ausführungsbeispiel ist das 25 thermische Anschlußteil auf der Montageseite für den Chip 5 mittig eingemeißelt, so dass eine Reflektowanne 16 für die von dem Chip 5 erzeugte Strahlung entsteht, an die sich die Re- flektorseitenwände 9 des Strahlungsaustrittsfensters 8 anschließen.

30 Im Unterschied zu dem vorigen Ausführungsbeispiel weist der so gebildete Gesamtreflektor 15 an der Übergangsstelle zwischen den Teilreflektoren 9,16 einen Knick auf. Durch diese Formgebung wird eine verbesserte Annäherung des Gesamtreflek- 35 tors 15 an ein Rotationsparaboloid und somit eine vorteil- hafte Abstrahlcharakteristik erreicht. Das vom Chip in einem steileren Winkel zur Bodenfläche der Wanne abgestrahlte Licht

15

wird stärker zur Hauptabstrahlrichtung 27 des Bauelements hin umgelenkt.

Zum Schutz des Chips ist das Strahlungsaustrittsfenster 8 mit einem Verguß 14, beispielsweise ein Reaktionsharz wie Epoxidharz oder Acrylharz, gefüllt. Zur Bündelung der erzeugten Strahlung kann der Verguß 14 nach Art einer Linse mit einer leicht gewölbten Oberfläche 18 geformt sein.

10 Um eine mechanisch stabile Verbindung von Verguß 14, Gehäusegrundkörper 1 und Leiterrahmen 2 zu erreichen, ist es vorteilhaft, die Höhe A der Reflektorschranke 16 des thermischen Anschlußteils geringer als die doppelte Höhe H des Chips 5 zu wählen. Die Höhe B des gesamten von dem thermischen Anschlußteil 4 teil 1 und dem Gehäusegrundkörper 1 gebildeten Reflektors ist sollte kleiner als die vierfache Höhe H des Chips 5 sein. Schließlich ist es vorteilhaft, das Strahlungsaustrittsfenster 8 so zu formen, daß für das Volumen V des Vergusses die obengenannte Relation

20

 $V \leq q \cdot H$ 

erfüllt ist, wobei q etwa  $7\text{mm}^3$  beträgt. Durch Erfüllung dieser Maßgaben wird die mechanische Stabilität und damit die Belastbarkeit und Lebensdauer des Bauelements vorteilhaft erhöht. Die Verankerung des thermischen Anschlußteils 4 mittels der Vorsprünge 19 in dem Gehäusegrundkörper 1 trägt ebenfalls hierzu bei.

25 Zur Herstellung eines solchen Bauelements wird zunächst für den Leiterrahmen 2 ein Trägerteil, das beispielsweise aus einem Trägerband zusammengesetzt wird, mit einer Öffnung bereitgestellt. Nachfolgend wird das thermische Anschlußteil 4 in die Öffnung des Trägerzils eingesetzt und mit dem Trägerteil 35 verquetscht.

16

Im nächsten Schritt wird auf dem thermischen Anschlußteil 4 der strahlungsemittierende Chip 5 aufgebracht, beispielsweise aufgelötet oder aufgeklebt. Zur Ausbildung des Gehäusegrundkörpers 1 wird der aus dem Trägerteil und dem thermischen Anschlußteil 4 gebildete Leiterrahmen 2 mit dem vormontierten Chip 5 von einer Formmasse umhüllt, wobei der der Chip 5 umgebende Bereich sowie der Kontaktanschlußbereich 10 ausge-  
spart wird. Dies kann beispielsweise in einem Spritzguß- oder Spritzpistolverfahren erfolgen. Von dem Kontaktanschlußbe-  
reich 10 wird abschließend eine Drahtverbindung 17 zu einer Kontaktfläche des Chips 5 geführt.

Alternativ kann nach der Verbindung von Trägerteil und thermischem Anschlußteil 4 der so gebildete Leiterrahmen 2 zuerst von der Formmasse umhüllt und der Chip 5 danach auf dem Chip-anschlußbereich 11 befestigt, vorzugsweise aufgeklebt, und kontaktiert werden.

Die Erläuterung der Erfindung anhand der beschriebenen Ausführungsbeispiele stellt selbstverständlich keine Einschränkung der Erfindung auf dieses Ausführungsbeispiel dar. Weitergehend können erfundengemäße Leiterrahmen und Gehäuse auch für andere Bauelemente, die eine effiziente Wärmeablei-  
tung erfordern, bzw. als Chip auch anderweitige Halbleiter-  
körper verwendet werden.

Das oben beschriebene Verfahren, umfassend die Schritte Be-  
reitstellen eines Leiterrahmens und Aufbringen des Chip, vor-  
zugswise durch Auflöten, vor einer Umhüllung des Leiterrah-  
mens mit einer Formmasse, wobei die Umgebung des Chips ausge-  
spart bleibt, ist auch auf andere Gehäusebauformen ohne ther-  
misches Anschlußteil übertragbar und stellt für sich schon  
eine Erfindung dar.

Die Vorteile dieses Verfahrens bestehen insbesondere darin,  
daß die Befestigung des Chips weitgehend unabhängig von den  
Eigenschaften der Formmasse optimiert werden kann. Ein Lö-

WO 03/064749

PCT/DE02/0106

17

- prozeß kann beispielsweise in einem erweiterten Temperaturbereich stattfinden. Dabei können Lote, vorzugsweise mit einer Schmelztemperatur über 260° C wie beispielsweise Hartlote, verwendet werden, die eine Verbindung mit sehr geringem Wärmeleitwert zwischen Chip und Leiterrahmen ausbilden. Weiterhin wird damit die Gefahr verringert, daß sich beim Auflegen eines entsprechenden Bauelements auf eine Leiterplatte der Chip ablösen könnte.

## Patentansprüche

1. Leiterrahmen (2) für ein strahlungsmittelndes Bauelement, vorzugsweise ein Lichtemissionsradiofrequenzbauelement, mit  
5 mindestens einem Chipmontagebereich (11), mindestens einem Drahtanschlußbereich (10) und mindestens einem externen elektrischen Anschlußtreffer (3a,b),  
dadurch gekennzeichnet, daß  
ein Trägerteil vorgesehen ist, das den Drahtanschlußbereich  
10 (10) und den Anschlußstreifen (3a,b) aufweist und in das ein  
separat gefertigtes thermisches Anschlußteil (4) eingeklebt  
ist, das den Chipmontagebereich (11) aufweist.
2. Leiterrahmen (2) nach Anspruch 1,  
15 dadurch gekennzeichnet, daß  
das Trägerteil eine Klemme oder Öse aufweist, in die das  
thermische Anschlußteil (4) eingekeilt ist.
3. Leiterrahmen (2) nach Anspruch 1 oder 2,  
20 dadurch gekennzeichnet, daß  
zwischen dem thermischen Anschlußteil (4) und dem Trägerteil  
eine Quetsch-, Niet-, Löt- oder Schweißverbindung vorgesehen  
ist.
- 25 4. Leiterrahmen (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
das thermische Anschlußteil (4) eine Reflektoranzeige (16) auf-  
weist, die den Chipmontagebereich (11) umfaßt.
- 30 5. Leiterrahmen (2) nach Anspruch 4,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
der Drahtanschlußbereich (10) gegenüber den Chipmontagebe-  
reich (11) von diesem aus gesehen erhöht angeordnet ist.
- 35 6. Leiterrahmen (2) nach Anspruch 5,  
dadurch gekennzeichnet, daß

WO 03094749

PCT/DE03/01306

- 19
- der Drahtanschlußbereich (10) vom Chipmontagebereich (11) geschen über dem Rand der Reflektorwanne (16) angeordnet ist.
7. Leiterrahmen (2) nach Anspruch 4, 5 oder 6,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
die Höhe (A) der Reflektorwanne (16) die zwelfache Höhe (H)  
eines zur Montage auf dem Chipmontagebereich (11) vorgesehe-  
nen Chips (8) nicht übersteigt.
8. Leiterrahmen (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,  
10 dadurch gekennzeichnet, daß  
das thermische Anschlußteil (4) Cu, Al, Mo, Fe, Ni oder W  
enthalt.
9. Leiterrahmen (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 8,  
15 dadurch gekennzeichnet, daß  
der Chipmontagebereich (11) mit einer Oberflächenvergütung  
zur Verbesserung der Chipmontage versehen ist.
10. Leiterrahmen (2) nach Anspruch 9,  
20 dadurch gekennzeichnet, daß  
die Oberflächenvergütung für die Chipmontage eine Ag- oder  
Au-Beschichtung umfaßt.
11. Leiterrahmen (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 10,  
25 dadurch gekennzeichnet, daß  
der Leiterrahmen (2) Cu oder Fe enthält.
12. Leiterrahmen (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 11,  
30 dadurch gekennzeichnet, daß  
der externe elektrische Anschlußstreifen (3a,b) eine Oberflä-  
chenvergütung zur Verbesserung der Bauelement-Montageeigen-  
schaften aufweist.
13. Leiterrahmen (2) nach Anspruch 12,  
35 dadurch gekennzeichnet, daß

20

die Oberflächenvergütung zur Verbesserung der Bauelement-Montageeigenschaften eine Ag-, Au-, Sn- oder Zn-Beschichtung umfasst.

- 5 14. Gehäuse für strahlungsemittierende Bauelemente, vorzugsweise Lichtemission dioden,  
durch gekennzeichnet, daß es einen Leiterrahmen (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 13  
enthält.

- 10 15. Gehäuse nach Anspruch 14,  
durch gekennzeichnet, daß das Gehäuse (1) einen Gehäusegrundkörper (1) aufweist, der aus einer Formmasse gebildet ist und in den der Leiterrahmen (2) derart eingebettet ist, daß der elektrische Anschlußstreifen (3a,b) aus dem Gehäusegrundkörper herausgeführt ist und eine thermische Anschlußfläche des thermischen Anschlußteiles (4) vom außen thermisch angeschließbar ist.

- 20 16. Gehäuse nach Anspruch 14 oder 15,  
durch gekennzeichnet, daß der Gehäusegrundkörper (1) ein Strahlungsaustrittsfenster (8) aufweist und das thermische Anschlußteil (4) derart in den Gehäusegrundkörper eingesetzt ist, daß der Chipmontagebereich (11) im Strahlungsaustrittsfenster (8) angeordnet ist.

- 25 17. Gehäuse nach Anspruch 16,  
durch gekennzeichnet, daß die Seitenwände (9) des Strahlungsaustrittsfensters (8) als Reflektorkörper geformt sind.

18. Gehäuse nach Anspruch 17,  
durch gekennzeichnet, daß das thermische Anschlußteil (4) eine Reflektorkonvexe (16) aufweist, die einen ersten Teilbereich eines Reflektors (15) bildet, der in einen zweiten, von den Seitenwänden (9) des

WO 03/064749

PCT/DE02/0136

- 21  
Strahlungsaustrittsfensters (8) gebildeten Teilbereich des  
Reflektors (15) übergreift.
19. Gehäuse nach Anspruch 18,  
5 dadurch gekennzeichnet, daß  
die Gesamthöhe (B) des Reflektors (15) die vierfache Höhe (H)  
eines zur Montage auf den Chipmontagebereich (11)vorgesehenen  
Chips (5) nicht übersteigt.
- 10 20. Gehäuse nach Anspruch 18 oder 19,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
Reflektorwände der Reflektorwanne (16) und die Reflektorflä-  
chen des Strahlungsaustrittsfensters (8) unterschiedliche  
Winkel mit der Hauptabstrahlungserichtung (27) des Bauelementes  
15 einschließen.
21. Gehäuse nach Anspruch 20,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
der von den Reflektorwänden der Reflektorwanne (16) mit der  
20 Hauptabstrahlungserichtung (27) eingeschlossene Winkel größer  
ist als der Winkel, der von den Reflektorflächen des Strah-  
lungsaustrittsfensters mit der Hauptabstrahlungserichtung (27)  
eingeschlossen ist.
- 25 22. Gehäuse nach einem der Ansprüche 14 bis 21,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
es oberflächenmontierbar ist.
23. Strahlungsemittierendes Bauelement mit einem strahlungs-  
emittierendem Chip (5),  
10 dadurch gekennzeichnet, daß  
es einen Leiterrahmen (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 13  
oder ein Gehäuse nach einem der Ansprüche 14 bis 22 aufweist.
- 35 24. Strahlungsemittierendes Bauelement nach Anspruch 23,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
der Chip (5) ein Halbleiterchip ist.

22

25. Strahlungsemittierendes Bauelement nach Anspruch 23 oder  
durch gekennzeichnet, daß  
5 der Chip (5) zumindest teilweise mit einer strahlungsdurch-  
lässigen Masse (14), insbesondere einer Kunststoffmasse, wie  
ein Gießharz oder eine Preßmasse umhüllt ist.

26. Strahlungsemittierendes Bauelement nach Anspruch 25,  
10 durch gekennzeichnet, daß  
die Kunststoffmasse ein Epoxidharz, ein Acrylharz, ein Sili-  
conharz oder eine Mischung dieser Harze enthält.

27. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach An-  
spruch 25 oder 26,  
15 durch gekennzeichnet, daß  
für das Volumen (V) der strahlungsdurchlässigen Masse (14)  
gilt:

$$V \leq q \cdot H,$$

wobei H die Höhe des Chips (5) und q ein Skalierungsfaktor  
ist, dessen Wert kleiner als  $10 \text{ mm}^3$  ist und vorzugsweise  $7 \text{ mm}^3$   
25 beträgt.

28. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach einem  
der Ansprüche 23 bis 27,  
durch gekennzeichnet, daß  
der Chip (5) auf dem Chipmontagebereich (11) des thermischen  
30 Anschlußteils (4) befestigt ist.

29. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach An-  
spruch 28,  
durch gekennzeichnet, daß  
35 der Chip (5) auf den Chipmontagebereich (11) aufgeklebt oder  
aufgelötet ist.

WO 03084749

PCT/DE02/0106

- 23
30. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach An-  
spruch 29,  
d a u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß  
der Chip (5) mittels eines Hartlots auf dem Chipmontagebe-  
reich (11) befestigt ist.
31. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach An-  
spruch 30,  
d a u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß  
10 die Schmelztemperatur des Hartlots größer als 260° C ist.
32. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach einem  
der Ansprüche 23 bis 31,  
d a u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß  
15 der Chip (5) mit dem Drahtanschlussbereich (10) mittels einer  
Drahtverbindung (17) elektrisch leitend verbunden ist.
33. Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbauelements  
nach einem der Ansprüche 23 bis 32,  
20 g e k e n n z e i c h n e t durch die Schritte  
- Bereitstellen eines Trägerteils,  
- Einklöpfen eines Chipmontagebereich (11) aufwei-  
sendes thermisches Anschlußteils (4) in das Trägerteil,  
- Aufbringen eines strahlungsemittierenden Chips (5) auf  
25 den Chipmontagebereich (11),  
- Einbetten des Trägerteiles (2) und des thermischen An-  
schlußteils (4) in eine Gehäuseformmasse.
34. Verfahren nach Anspruch 33,  
30 d a u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß  
der thermische Anschlußteil (4) durch Verkneten, Verguschen  
oder Verlöten mit dem Trägerteil verbunden wird.
35. Verfahren nach Anspruch 33 oder 34,  
35 d a u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß

WO 03/064749

PCT/DE03/0136

24

der Chip (5) vor dem Einbetten des Trägerteils und des thermischen Anschlußteiles (4) in die Gehäuseformmasse auf den Chipmontagebereich (11) aufgebracht wird.

5

36. Verfahren nach einem der Ansprüche 33-bis 35, dadurch gekennzeichnet, daß der Chip (5) auf den Chipmontagebereich (11) aufgelötet wird, wobei die Lötttemperatur größer als 260 °C ist.

10

37. Verfahren nach einem der Ansprüche 33 bis 36, dadurch gekennzeichnet, daß der Chip (5) mittels eines Hartlotes auf dem Chipmontagebereich (11) befestigt wird.

15

38. Verfahren nach einem der Ansprüche 33 bis 37, dadurch gekennzeichnet, daß das Einbetten des Trägerteils (2) und des thermischen Anschlußteils (4) in eine Gehäuseformmasse mittels eines Spritzguss- oder Spritzpreßverfahrens erfolgt.

20

WO 03/084749

PCT/DE03/01306

1/3

FIG 1a

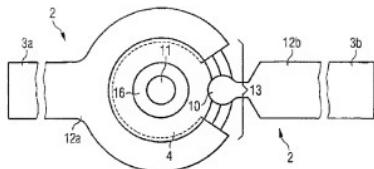
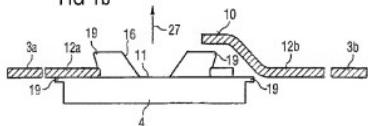


FIG 1b



WO 03/084749

PCT/DE2003/01306

2/3

FIG 2

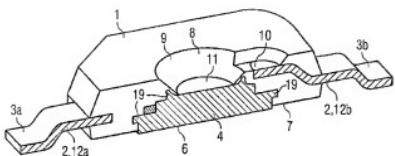


FIG 3

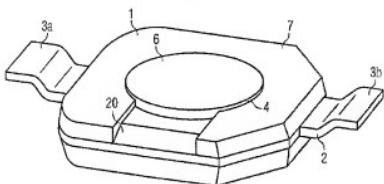


FIG 4

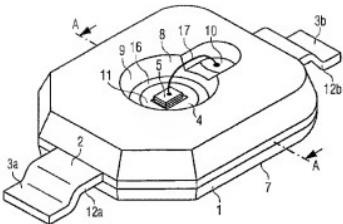
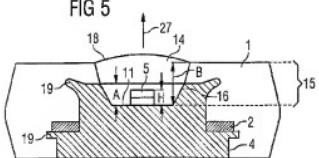


FIG 5





---

WO 02/084749 A3 

(8) Veröffentlichungsdatum des internationales  
Rechtschutzbereichs:

13. Mai 2003

Zur Aklärung der Zweckbestimmung und der anderen  
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Objectives, Nomenclature  
and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe  
der PCT-Gesetz verwiesen.

【國際調查報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/US 02/01395
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER		
IPC 7    H01L33/09		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minespace documentation searched (classification system selected by classification symbol)		
IPC 7    H01L		
Documentation searched other than minespace documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Information data base consulted during the international search (name of data base and, where applicable, search terms used)		
EPO-Internal, PAI		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Classification of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Reference to column No
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Vol. 1991, no. 02. 20, November 1990. (1990-02-02) → 8 JP 02 30545 A (CITIZEN ELECTRON CO). 13. November 1990 (1990-11-13) Paragraph [0020]-[0022]	1-3, B-14, 22-26, 28-38
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Vol. 1991, no. 02. 30, November 1990 (1990-03-10) → 8 JP 11 340605 A (BOHN CO LTD). 14. December 1990 (1990-12-14) Paragraph 3,4	4-7  6-7
X	DE 40 27 697 A (ROBERT BOSCH GHM) 5, December 1991 (1991-12-05) column 1, ln 25 "column", ln 24 -/-	1-3,5, 8-15
[X] Further documents are listed in the continuation of Box C.		[X] List patent family names
* Fields of endeavour		These documents disclosed either the international filing date or priority date and/or mention the name of the inventor(s) and/or mention the name of the attorney or entity conducting the research.
** National classification of the subject matter of the cited article is not mentioned		Assignment of publication numbers, the cited invention can be identified from the classification symbol.
*** earlier documents not published prior to or on the international filing date		Assignment of publication numbers, the cited invention can be identified from the classification symbol.
**** earlier documents published prior to or on the international filing date, but not cited as prior art		Assignment of publication numbers, the cited invention can be identified from the classification symbol.
***** documents relating to the same disclosure, whether published or otherwise		Assignment of publication numbers, the cited invention can be identified from the classification symbol.
***** documents published prior to the international filing date but later than the international filing date		Assignment of publication numbers, the cited invention can be identified from the classification symbol.
Data of the initial compilation of the international search		Date of mailing of the international search report
27 August 2002		25.11.2002
Name and mailing address of the ISA		Arranged office
The Hague Office P.O. Box 2000 NL-2500 AH The Hague		vander Linden, J
Phone/fax No.		Telephone No

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/EP 02/01396
C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Description of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Referred to page No.
X	DE 23 15 709 A (ELECTRUM (DE)) 16. October 1974 (1974-10-16)	1-3, 8-11, 22-24, 28-38
	page 4, Abstract 2 - page 5, Paragraphe 1 ---	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 11, 29 December 1995, (1995-12-29) 29-30 EP 0 720 271 A1 (MITSUBISHI ELECTRIC), 4. August 1995 (1995-08-04)	1-4-15, 22-24, 28-38
	Paragraphe [0023], Figure 5 ---	
A	WO 99 55914 A (GENTEX CORP.) 21 September 2000 (2000-09-21)	1-4, 8-15, 22-24, 28-38
	page 10, Paragraphe 2 -Seite 40, Paragraphe 2 ---	
P,X	EP 1 133 439 A (ELBUD (DE)) 4. October 1991 (1991-10-04)	1-5, 8-11, 22-24, 28-38
	Paragraphe [0031]-[0031] ----	

Form PCT/ISA/210 (continuation of search sheet) (July 1992)



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.  
PCT/DE 02/01306

The International Searching Authority has determined that this international application contains more than one invention or group of inventions, namely

1. Claims 1-15, 22-26 and 28-38

lead frame, housing and radiation-emitting component, a thermal connecting part being attached in a support part of the lead frame.

2. Claims 16-21 and 27

housing and radiation-emitting component, a thermal connecting part being attached in a support part of the lead frame, and the housing having a radiation exit aperture with reflector surfaces, which is filled with a compound.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT Information on patent family members				International Application No. PCT/DE 02/01306
Patent document cited in search report	Publishing date	Patent family number(s)	Publishing date	
JP 1030464 A	13-11-1969	NON		
JP 1134606 A	14-12-1969	1808289 EP 1081261 A1 MO 9963594 A1 US 4169284 B	11-07-2001 07-02-2001 05-12-1999 11-12-2000	
DE 4017697 A	05-12-1981	BE 4017497 A1 CH 2915152 A JP 4230056 A US 5345106 A US 5292254 A	05-12-1991 05-12-1991 19-08-1992 06-09-1994 11-04-1994	
DE 2315795 A	10-10-1974	DE 2315795 A1		10-10-1974
JP 9224221 A	04-06-1980	JP 3227254 B2		12-11-2001
WO 9653938 A	22-09-2000	MO 6335548 B1 AB 3527990 A EP 3099098 A EP 11699335 A1 EP 11699335 A1 MO 2000154379 A1 US 2002154379 A1 US 6419413 B1 US 200204251 A1 US 200204251 A1		01-01-2002 04-19-2000 04-19-2000 05-08-2001 09-01-2002 21-01-2002 16-10-2002 27-08-2002 04-01-2002 10-01-2002
EP 1139439 A	04-10-2001	CA 2342567 A1 EP 1139419 A1 US 20010109666 A1	30-09-2001 04-10-2001 10-10-2001	

Form PCT/ISA/218 (patent family annex) (July 2002)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT		Intern. Attestations PG1/SE 02/01395
1. KASERNE DER ANHALTENDEN ERKENNTNISSE 1PK 7 H01132/00		
Hinweis: Identifiziert Pionierinventen (PPI) oder die wichtigsten Erkenntnisse und deren a. VERFASSERINNEN GRUNDT Ergebnisse der Recherche (Patentanmeldungen/Veröffentlichungen)		
1PK 7 H01A		
Recherchierer ist über diese vom Hersteller hergestellte Auskunft informiert, sofern dies dieser die nachfolgenden Gütekriterien erfüllt:		
Während der Recherche keine Konkurrenz erkannt wurde (Vorhandensein eines Gleiches), und es kein weiterer Nachschlag vorgenommen wurde.		
EPO-Internal, PAJ		
b. ALLE WESENTLICHEN PIONIERINVENTAUSLAGEN		
Kategorie: Beschreibung der Veröffentlichung, aus der sich das unter Angabe des Rechtsinhabers und Titels		Art. Ausprägung Nr.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 02, 26. Februar 1999 [1998-02-25] -> JP 09 224012 A [BOSCH ELECTRON CO], 13. November 1998 [1998-11-13] Abstract [0620]-[0622]	1-3, 3-14, 22-26, 23-35
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, 26. Februar 1999 [1998-02-25] -> JP 11 344959 A [BOSCH CO LTD], 14. Februar 1999 [1999-02-14] Abstract [0620]-[0622]	4-7
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, 26. Februar 1999 [1998-02-25] -> JP 11 344959 A [BOSCH CO LTD], 14. Februar 1999 [1999-02-14] Abstract [0620]-[0622]	4-7
X	DE 40 17 497 A [ROBERT BOSCH (WHR)] 5. Dezember 1993 [1993-12-05] Spalte 1, Zeile 25- Spalte 3, Zeile 24 *** -/-/	1-3, 5, 5-15
<input checked="" type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Untersuchung von Feld C (siehe unten)		<input checked="" type="checkbox"/> Weitere Aufschlussinformationen
<p><sup>1</sup> Ausschließliche Kategorien von eingetragenen Veröffentlichungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-&gt; Patent: Eintragung einer Patentschrift, die nach dem Internationalen Patentatbestand (Anmeldung noch bevor sie, sondern vor dem Veröffentlichungsdatum des Intern. Patentatbestands, in einem anderen Land als dem Land der Anmeldung veröffentlicht wurde)</li> <li>&gt; P: Eintragung einer Patentschrift, die nach dem Internationalen Patentatbestand (Anmeldung noch bevor sie, sondern vor dem Veröffentlichungsdatum des Intern. Patentatbestands, in einem anderen Land als dem Land der Anmeldung veröffentlicht wurde)</li> <li>&gt; V: Veröffentlichung eines Dokuments, das eine Erfindung beschreibt und auf die Anmeldung eines Patentschriftes abgestimmt ist, jedoch nicht als Patentschrift eingetragen ist (z.B. ein Patentantrag, der auf eine vorliegende Erfindung, eine Erfindung, die eine Ausbildung einer endlichen Erfindung beinhaltet, oder eine Erfindung, die mit einer endlichen Erfindung zusammenhängt)</li> <li>&gt; D: Eintragung einer Patentschrift, die nach dem Internationalen Patentatbestand (Anmeldung noch bevor sie, sondern vor dem Veröffentlichungsdatum des Intern. Patentatbestands, in einem anderen Land als dem Land der Anmeldung veröffentlicht wurde)</li> </ul>		
Zeitraum der Untersuchung der internationalen Recherche		Ablaufdaten der internen Recherche des Rechters
27. August 2002		25.11.2002
Name und Adresse des Rechters für die internationale Recherche Europäisches Patentamt, P.O. 18154 Potsdam-D Europäischer Patentamt, P.O. 18154 Potsdam-D TM - 100-105 (48-000) Tx 204014949-14 DE 002-000-000-000-000-000		Anschrift/Name des Rechters: van der Linden, J

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT		DEUTSCH	ENGLISCH
Kategorie	Relevantes Patent oder Veröffentlichung, aus dem die Anwendung abweichen kann	Patent-Nr./Veröffentlichungs-Nr.	Best-Jessica-ID
X	DE 23 15 709 A (LICENTIA OHG) 16. Oktober 1974 (1974-10-16)  Seite 4, Absatz 2 -Seite 5, Absatz 1	1-3, 8-15, 23-26, 28-38	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 11: EP 1 159 439 A (MITSUBISHI ELECTRIC) -8, -9, -10 07 26/22/95 A (MITSUBISHI ELECTRIC), 4. August 1995 (1995-08-04) Absatz [0026]; Absatz 1-9 ...  WO 90 05014 A (DURVET CORP) 21. September 1990 (1990-09-21)	1-4, 8-15, 22-26, 28-36	
A	Seite 39, Absatz 2 -Seite 40, Absatz 2		
P,X	EP 1 159 439 A (DURVET CORP) 4. Oktober 2002 (2002-10-04)  Absätze [0023]-[0033]	1-5, 8-15, 22-26, 28-36	

<p><b>INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT</b></p>	<p>Basis: Administration PCI / BE / 02/0136</p>
---	---

**Feld 1:** Bezeichnungen zu den Angebotsleistungen, die durch eine nicht medizinische Institutionen erbracht werden (Fragestellung von Punkt 2 auf Seite 1)

Gemäß Artikel 1(1) wird die folgende Gleichheit der bestimmte Ausprägung nicht berücksichtigt:

Angebote Nr. 1, welche von einer Organisation bestellt, werden Recherche die die Rechte nicht verletzen, die ebenso

Angebote Nr. 2, welche von einer Organisation bestellt, werden Recherche die die Rechte nicht verletzen, dass eine eindeutige interdisziplinäre Recherche nicht ausreichend wieder herstellt.

Angebote Nr. 3, welche von einer Organisation bestellt, werden Recherche die die Rechte nicht verletzen, dass eine eindeutige interdisziplinäre Recherche nicht ausreichend wieder herstellt.

Angebote Nr. 4, welche von einer Organisation bestellt, werden Recherche die die Rechte nicht verletzen (Feld 2 und 3 (Feld 4, 5, 6) abgedeckt sind).

**Feld 2:** Kennzeichnung bei mehrstufiger Erfolgschancen der Erteilung (Fragestellung von Punkt 3 auf Seite 1)

Die hieraus resultierende Reaktionsschwäche hat festgestellt, dass diese Preisträger Anwendung seines Erfolges erzielte

siehe Zusatzblatt

Die für den Berater/Institut ausreichende oder gesuchte Recherchequalität nicht gewährleistet ist, entweder auch dieser Recherchequalität nicht entsprechen kann, die von anderen Organisationen erbracht werden.

Die für alle Rechercheanbieter Ausprägung die Recherche oft einen Ausnahmefall darstellen könnte, kann eine ausreichende Recherche nicht gewährleistet werden, kann die Recherche nicht zur Zeitung der vorliegenden Angebotsleistung.

Der Anbieter/Institut der Beratung und/oder der Rechercheinstellung kann die Ergebnisse verdeckt erhalten, entweder sich dieser interdisziplinäre Rechercheauftrag nicht auf die Angebotsleistung, für den die Recherche instand gesetzt wurde, bezieht oder nicht Angebote Nr. 1, 2, 3.

Der Anbieter/Institut der Beratung und/oder der Rechercheinstellung kann die Ergebnisse verdeckt erhalten, entweder sich dieser interdisziplinäre Rechercheauftrag nicht auf die Angebotsleistung, für den die Recherche instand gesetzt wurde, bezieht oder nicht Angebote Nr. 1-15, 22-26, 28-30.

**Bewertungen:** Inhaltlich einer Werteskalierung

- Die vorliegende Leistung kann von zentralisatorischer Qualität gesehen.
- Die Zeilung ausgewählter Rechercheobjekten erfolgt ohne Kriterien.

WEITERE ANGABEN	
PCT/RM/ 216	
Internationale Anmeldung PCT/DE 92/01306	
Die internationale Recherchebehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:	
1. Anspruch 1-15, 22-26, 28-38 Leiterrahmen, Gehäuse und strahlungsausmittigendes Baulement wobei ein thermisches Anschlußteil in ein Trägerteil des Leiterrahmen eingebracht ist, und das Gehäuse einen Grundkörper und ein Strahlungsausstoffsfenster mit Reflexionsflächen aufweist, das mit einer Paste gefüllt ist.	
2. Anspruch 16-21, 27 Gehäuse und strahlungsausmittigendes Baulement wobei ein thermisches Anschlußteil in ein Trägerteil des Leiterrahmen eingebracht ist, und das Gehäuse einen Grundkörper und ein Strahlungsausstoffsfenster mit Reflexionsflächen aufweist,	

INTERNATIONALESUCHERKENBERICHT			Meldung	in Patentdokument
Angaben zur Veröffentlichung der vorliegenden Patentanmeldung			PCT/DE 02/6196	
Im Rechtsschutz erlangtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Meldungsdatum Patentanmeldung	Datum der Veröffentlichung	
JP 10034484 A	13-11-1998	KEINE		
JP 11346006 A	14-12-1999	CH EP WO TR	130539 T 1001761 A1 9901761 A1 11-024 B	11-07-2001 07-05-2001 09-05-1999 11-12-2001
DE 40117697 A	05-12-1991	JP US	2971101 B2 5302100 A	02-11-1999 06-01-1993
DE 2315700 A	10-11-1971	DE	2315700 A1	10-07-1971
JP 07262271 A	04-09-1995	JP	3227292 B2	12-11-2001
WO 9605914 A	21-09-2000	US	6355468 B1 3577969 A 3577970 A EP L1106150 A1 L1106151 A1 WO 0852912 A1 20021514779 A1 US 20010720111 A1 US 20020542511 A1	01-01-2002 04-10-2003 04-10-2003 09-01-2002 09-01-2002 09-01-2002 21-01-2002 24-10-2002 27-01-2002 04-10-2001 04-10-2001 10-01-2001
EP 1139439 A	04-10-2003	CA EP US	2342767 A1 1139439 A1 2003059605 A1	30-09-2001 04-10-2001 10-10-2001

Formular PCT/DE/02/6196 (Antrag Patentanmeldung) 1/2

---

フロントページの続き

(74)代理人 100114890  
弁理士 アインゼル・フェリックス=ラインハルト  
(74)代理人 230100044  
弁護士 ラインハルト・アインゼル  
(72)発明者 ゲオルク ポーゲナー  
ドイツ連邦共和国 ラバースドルフ アム ザントビューゲル 12  
(72)発明者 ヘルベルト ブルンナー  
ドイツ連邦共和国 レーゲンスブルク ヴィンクラーガッセ 16  
(72)発明者 ミヒャエル ヒーグラー  
ドイツ連邦共和国 レーゲンスブルク キラーマンシュトラーセ 45  
(72)発明者 ギュンター ヴァイトル  
ドイツ連邦共和国 レーゲンスブルク ブラッシュヴェーク 3  
F ターム(参考) 5F041 AA03 AA33 AA44 DA25 DA36 DA44 DM45 DB09